

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 948 813 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
10.07.2002 Patentblatt 2002/28

(51) Int Cl.7: **H01L 23/498**

(21) Anmeldenummer: **97913093.7**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE97/02320

(22) Anmeldetag: **09.10.1997**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 98/16953 (23.04.1998 Gazette 1998/16)

(54) **CHIPMODUL SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES CHIPMODULS**

CHIP MODULE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

MODULE A PUCES ET SON PROCEDE DE PRODUCTION

(84) Benannte Vertragsstaaten:
FR GB

(30) Priorität: **14.10.1996 DE 19642358**
22.01.1997 DE 19702014

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.10.1999 Patentblatt 1999/41

(73) Patentinhaber: **Pac Tech - Packaging**
Technologies GmbH
14641 Nauen (DE)

(72) Erfinder:
• **OPPERMANN, Hans-Hermann**
D-10965 Berlin (DE)
• **ZAKEL, Elke**
D-14612 Falkensee (DE)

• **AZDASHT, Ghassem**
D-14052 Berlin (DE)
• **KASULKE, Paul**
D-10551 Berlin (DE)

(74) Vertreter: **Böck, Bernhard, Dipl.-Ing. et al**
Patentanwälte Böck + Tappe Kollegen,
Kantstrasse 40
97074 Würzburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 582 052 **EP-A- 0 683 513**
EP-A- 0 702 404

• **HEITMANN R: "THE ULTIMATE CONNECTIONS:**
BGA AND FLIP CHIP ATTACHMENT"
ELECTRONIC PACKAGING AND PRODUCTION,
Bd. 36, Nr. 5, 1. Mai 1996, Seiten 68-70, 72, 74 - 76,
XP000589071

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 0 948 813 B1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Chipmodul mit einem Chipträger und mindestens einem Chip, wobei der Chipträger als Folie ausgebildet ist mit einer Trägerschicht aus Kunststoff und einer Leiterbahnstruktur mit Leiterbahnen, und der Chipträger unter zwischenliegender Anordnung eines Füllstoffs mit dem Chip verbunden ist, wobei die Leiterbahnen auf ihrer Vorderseite mit Anschlußflächen des Chips verbunden sind und auf ihrer Rückseite Außenkontaktbereiche zur Ausbildung einer flächig verteilten Anschlußflächenanordnung zur Verbindung des Chipmoduls mit einem elektronischen Bauelement oder einem Substrat aufweisen. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Chipmoduls.

[0002] Chipmodule der vorgenannten Art dienen beispielsweise dazu, um ausgehend von der sehr dichten, peripheren Anschlußflächenanordnung eines Chips über den mit einer Leiterbahnstruktur versehenen Chipträger eine flächig verteilte, weniger dichte Anschlußflächenanordnung zur Verbindung des Chips mit einer Platine oder dergleichen in konventioneller SMT(Surface-Mounted-Technology)-Technik zu ermöglichen. Ein ausreichend großer Abstand zwischen den einzelnen Anschlußflächen der Anschlußflächenanordnung erweist sich insbesondere deswegen als wichtig, weil die äußere Anschlußflächenanordnung in der Regel in einem Umschmelz(Reflow)-Verfahren mit der Platine oder dergleichen verbunden wird. Bei zu geringem Abstand zwischen den einzelnen Anschlußflächen kann es zu Kurzschlußverbindungen zwischen einzelnen Lotbumps der Anschlußflächenanordnung kommen.

[0003] Aufgrund zunehmender Anforderungen an die Miniaturisierung der Chipmodule wurden in der Vergangenheit, ausgehend von sogenannten "BGA"(Ball-Grid-Array)-Anschlußflächenverteilungen, Chipmodule entwickelt, die als "CSP"(Chip-Size-Package oder auch Chip-Scale-Package) bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den vorgenannten BGAs, bei denen die flächige Umverteilung der Chipanschlußflächen auf einer im Vergleich zur Chipoberfläche wesentlich größeren Oberfläche mittels entsprechend großer Chipträger erfolgt, steht bei den mit CSP bezeichneten Chipmodulen für den Chipträger nur eine Fläche zur Verfügung, die im wesentlichen mit der Oberfläche des Chips übereinstimmt. Daher erweist es sich bei den CSPs als wesentlich, die zur Verfügung stehende Fläche bestmöglich auszunutzen.

[0004] Bei bekannten CSPs, wie sie beispielsweise aus der US-PS 5,367,763 oder aus "Proceedings of the 1993 International Symposium on Microelectronics (ISHM), Dallas, Texas, pp. 318-323" bekannt sind, wird der Randbereich der für den Chipträger zur Verfügung stehenden, mit der Oberfläche deckungsgleichen Fläche für die Anschlußverbindungen zwischen den Anschlußflächen des Chips und der Leiterbahnstruktur des Chipträgers verbraucht, so daß der Chipträger sich nur

in einem um den Randbereich verminderten Innenflächenbereich erstreckt. Bei derart gebildeten Chipmodulen ist es daher notwendig, zur Erreichung einer vollständigen, auch die Anschlußflächen des Chips isolierend abdeckenden Gehäusung die Peripherie der Chipoberfläche in einem nachfolgenden Arbeitsschritt mit einer separaten Abdeckung, beispielsweise einem Verguß, zu versehen.

[0005] Aus der EP-A-0 702 404 ist ein Chipmodul bekannt, das einen Chipträger und einen Chip aufweist, wobei der Chipträger zur Verbindung von Leiterbahnen mit den Anschlußflächen des Chips eine zentrale Ausnehmung aufweist und sich somit peripher zur Chipoberfläche erstreckt.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Chipmodul bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls vorzuschlagen, das eine bessere Ausnutzung der zur Anordnung des Chipträgers zur Verfügung stehenden Chipoberfläche bei gleichzeitig möglichst einfachem Aufbau des Chipmoduls ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Chipmodul mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst.

[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Chipmodul verlaufen die Leiterbahnen in einer Ebene auf der dem Chip zugewandten Chipkontaktseite der Trägerschicht. Hierdurch steht die Trägerschicht selbst zur voneinander isolierten Anordnung der umverteilten Anschlußflächen zur Verfügung, so daß die Außenkontaktbereiche zur Ausbildung der flächig verteilten Anschlußflächenanordnung durch Ausnehmungen in der Trägerschicht gebildet werden können, die sich gegen die Rückseite der Leiterbahn erstrecken. Darüber hinaus erstreckt sich die Trägerschicht bei dem erfindungsgemäßen Chipmodul über den Bereich der Anschlußflächen des Chips, so daß die gesamte Chipoberfläche durch die Trägerschicht des Chipträgers abgedeckt wird. Insgesamt resultiert hieraus ein sehr einfacher Aufbau und eine entsprechend einfache Herstellungsmöglichkeit des Chipmoduls.

[0009] In einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Chipmoduls ist die Trägerschicht des Chipträgers im Überdeckungsbereich mit den Anschlußflächen des Chips geschlossen ausgebildet, so daß selbst dieser Überdeckungsbereich im peripheren Bereich der Chipträgeroberfläche zur Anordnung von äußeren Anschlußflächen auf der Chipträgeroberfläche zur Verfügung steht.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Chipmoduls weist der Chipträger eine Trägerschicht auf, die in einem Überdeckungsbereich mit den Anschlußflächen des Chips Öffnungen hat, welche sich gegen die Rückseite der Leiterbahnen erstrecken und zur Aufnahme von die Leiterbahnen mit den zugeordneten Anschlußflächen elektrisch verbindendem Verbindungsmaterial dienen.

[0011] Diese Ausführungsform des Chipmoduls er-

möglicht eine Herstellung, bei der sowohl die Ausnehmungen in der Trägerschicht, die zur Aufnahme von Verbindungsmaterial für die Kontaktierung des Chipmoduls mit einer Platine oder anderen Bauteilen vorgesehen sind, als auch die Öffnungen in der Trägerschicht in ein und demselben Verfahrensschritt mit Verbindungsmaterial befüllt werden können.

[0012] Die Ausführung des Chipmoduls gemäß Anspruch 4 ermöglicht eine gute Zugänglichkeit der Chipanschlußflächen für das Verbindungsmaterial, so daß eine hohe Kontaktsicherheit gewährleistet wird.

[0013] Für den Fall, daß eine Versiegelung bzw. mechanische Stabilisierung des Verbunds aus Chip und Chipträger allein aufgrund des zwischen dem Chip und dem Chipträger angeordneten Füllmaterials nicht ausreichend ist, kann zur Ergänzung längs der Peripherie des Chips verlaufend ein vorzugsweise aus dem Füllmaterial gebildeter Stützrahmen vorgesehen sein. Hierdurch wird in jedem Fall eine wirksame mechanische Stabilisierung des Chipmoduls erreicht, ohne daß hierzu die durch den Chip vorgegebenen Abmessungen des Chipmoduls wesentlich vergrößert werden müßten.

[0014] Alternativ zur vorgenannten Möglichkeit besteht jedoch auch die Möglichkeit, eine Versiegelung bzw. mechanische Stabilisierung des Chipmoduls durch einen Verguß des Chips vorzusehen, der die Seitenflächen des Chips mit einem die Chipoberfläche überragenden Überstand des Chipträgers verbindet. Diese Art der Versiegelung bzw. mechanischen Stabilisierung des Chipmoduls ist besonders dann vorteilhaft, wenn ein Chipmodul nach Art eines Chip-Size-Package geschaffen werden soll, bei der die Chipträgeroberfläche etwas größer als die Chipoberfläche ist, wodurch das Chipmodul einen Überstand des Chipträgers aufweist.

[0015] Für die Durchführung der Montage des Chipmoduls auf einem Substrat oder einer Platine in der bekannten SMT-Technik, bei der die auf der Chipträgeroberfläche angeordneten, beispielsweise mit Lotmaterial versehenen Außenkontaktbereiche mit entsprechend angeordneten Gegenkontakten auf dem Substrat oder der Platine verbunden werden, erweist es sich als vorteilhaft, wenn die Außenkontaktbereiche der Chipträgeroberfläche mit Lotmaterial versehen sind, dessen Schmelzpunkt niedriger ist als die zur thermischen Verbindung zwischen den Kontaktmetallisierungen des Chips und den Leiterbahnen des Chipträgers notwendige Temperatur. Hierdurch wird sichergestellt, daß es aufgrund der Temperaturbeaufschlagung des Chipmoduls zur Durchführung der Lötverbindung zwischen dem Chipträger und dem Substrat bzw. der Platine nicht zu einer Destabilisierung der Verbindungen zwischen den Kontaktmetallisierungen des Chips und den Leiterbahnen des Chipträgers kommen kann.

[0016] Als besonders vorteilhaft für die Herstellung von Chipmodulen erweist es sich, wenn die Chipmodule erfindungsgemäß in einem Modulverbund, der gebildet ist aus einem Chipträgerverbund mit einer Vielzahl zusammenhängend ausgebildeter Chipträger und einem

Chipverbund, insbesondere einem Wafer mit einer Vielzahl zusammenhängend ausgebildeter Chipeinheiten oder Dies, zusammengefaßt sind.

[0017] Bei Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Anspruch 9 zur Herstellung erfindungsgemäßer Chipmodule erfolgt zunächst ein Auftragen eines fließfähigen Füllmaterials auf die Chipoberfläche oder die Chipkontaktseite des Chipträgers. Dieses Füllmaterial dient einerseits zur abdichtenden Anordnung des Chipträgers auf dem Chip und andererseits zur mechanischen Stabilisierung des Chipträgers auf dem Chip. Das Füllmaterial kann auch Klebeeigenschaften zur Ausbildung eines flächigen Verbunds zwischen dem Chip und dem Chipträger aufweisen. Durch ein aneinander Andrücken des Chipträgers und des Chips erfolgt eine Verteilung des Füllmaterials im Spalt zwischen der Chipkontaktseite des Chipträgers und der Chipoberfläche. Aufgrund der Kontaktierung der Leiterbahnen mit den zugeordneten Kontaktmetallisierungen des Chips durch eine rückwärtige Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen unter Zwischenlage der Trägerschicht bleibt auch bei der Kontaktierung die Oberfläche der Trägerschicht des Chipträgers geschlossen, so daß eine Verdrängung des Füllmaterials nur zur Seite hin erfolgen kann. Damit ist sichergestellt, daß das Füllmaterial die gesamte Chipoberfläche bedeckt und somit nach Herstellung der Verbindung zwischen dem Chipträger und dem Chip keine zusätzlichen Maßnahmen zur Ergänzung von Füllmaterial notwendig sind. Vielmehr erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Kontaktierung des Chipträgers auf dem Chip und die Stabilisierung des Chipmoduls durch Verteilung eines Füllmaterials im Spalt zwischen dem Chipträger und dem Chip in einem einzigen Arbeitsschritt.

[0018] Anspruch 10 betrifft ein alternatives erfindungsgemäßes Verfahren, bei dem anstatt des Auftragens von Füllmaterial ein bereits mit einer Kleberschicht versehener Chipträger verwendet wird.

[0019] Darüber hinaus bleibt infolge der vorgenannten rückwärtigen Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen zur Kontaktierung des Chipträgers auf dem Chip und der dadurch erhaltenen Geschlossenheit der Trägerschicht des Chipträgers auch im Peripheriebereich des Chips die Möglichkeit, Außenkontaktbereiche zur Ausbildung der flächig verteilten Anschlußflächenanordnung auf der Chipträgeroberfläche vorzusehen.

[0020] Eine Alternative zu dem vorstehend erörterten erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung einzelner Chipmodule besteht in dem erfindungsgemäßen Verfahren nach Anspruch 11, das die Herstellung einzelner erfindungsgemäßer Chipmodule durch Vereinzelung aus einem Modulverbund betrifft, in dem eine Vielzahl erfindungsgemäß ausgebildeter Chipmodule zusammenhängend ausgebildet sind. Hierzu erfolgt zunächst die Herstellung des Modulverbunds mit einem Chipträgerverbund und einem Chipverbund gemäß Anspruch 8 und anschließend die Herstellung einer Mehrzahl einzelner Chipmodule durch Vereinzelung von Ein-

heiten aus zumindest einem Chip und einem damit kontaktierten Chipträger aus dem Modulverbund.

[0021] Dieses erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht demnach die Herstellung von Chipmodulen auf Waferebene, wodurch mit relativ wenigen Handhabungs- oder Fertigungsschritten nicht nur die Herstellung eines einzelnen, sondern vielmehr die gleichzeitige Herstellung einer Vielzahl von Chipmodulen möglich wird.

[0022] Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn zur Herstellung des Modulverbunds die nachfolgende Reihenfolge von Verfahrensschritten gemäß Anspruch 12 eingehalten wird:

[0023] Zunächst erfolgt die Bereitstellung eines Wafers, der mit erhöhten Kontaktmetallisierungen, die fachsprachlich auch als sogenannte "Bumps" bezeichnet werden, versehen ist, und die Bereitstellung eines Chipträgerverbunds, der eine Vielzahl von auf einer gemeinsamen Trägerschicht angeordneten Leiterbahnstrukturen mit Leiterbahnen aufweist, wobei die Leiterbahnstrukturen einer jeweils definierten Anzahl von im Wafer zusammenhängend ausgebildeten Chips zugeordnet sind. Anschließend erfolgt der Auftrag eines fließfähigen Füllmaterials auf die Kontaktfläche des Wafers oder die Chipkontaktseite des Chipträgerverbunds, wobei es sich bei diesem Füllmaterial beispielsweise um einen Epoxyd-Kleber handeln kann. Der Auftrag des Füllmaterials auf den Wafer kann als flächenförmig begrenzter Auftrag im Zentrum des Wafers erfolgen, gefolgt von einer Verteilung des Füllmaterials auf der Waferoberfläche durch eine Rotation des Wafers um seine Mittelpunktschse. Vor der flächigen Verbindung des Chipträgerverbunds mit dem Wafer, die beispielsweise durch einen Laminiervorgang durchgeführt werden kann, erfolgt eine Relativpositionierung des Wafers und des Chipträgerverbunds, derart, daß sich eine Überdeckungslage zwischen den Kontaktmetallisierungen des Wafers und Kontaktbereichen der zugeordneten Leiterbahnen der Leiterbahnstrukturen einstellt. Schließlich erfolgt die flächige Verbindung zwischen dem Wafer und dem Chipträgerverbund, beispielsweise durch den vorstehend erwähnten Laminiervorgang, wobei der endgültigen Verbindung eine Vorfixierung in ausgewählten Punkten vorausgehen kann. Nach Herstellung der flächigen Verbindung oder gleichzeitig mit dieser erfolgt die Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen des Wafers mit den zugeordneten Leiterbahnen des Chipträgerverbunds.

[0024] Bei einer zum vorstehend erläuterten Verfahren gemäß Anspruch 12 alternativen Vorgehensweise gemäß Anspruch 13 wird anstatt des Auftragens von Füllmaterial ein bereits mit einer Kleberschicht versehener Chipträgerverbund verwendet.

[0025] Wie bereits vorstehend im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung eines einzelnen Chipmoduls erwähnt wurde, kann auch bei der Herstellung des gesamten Modulverbunds die Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen des Wafers mit den Leiterbahnen des Chipträgerverbunds durch die

Trägerschicht des Chipträgerverbunds hindurch erfolgen, also beispielsweise durch eine rückwärtige Kontaktierung ohne Zerstörung der Trägerschicht im Bereich der Kontaktstellen.

[0026] Als Hilfsmittel zur Relativpositionierung kann der Wafer mit mindestens zwei Positionierungsstiften versehen sein, die in korrespondierend ausgebildete Positionierungsöffnungen in der Trägerschicht des Chipträgerverbunds eingreifen. Derartige Positionierungsstifte können als "Dummy bumps" ausgebildet sein, die, ohne an der elektrischen Verbindung zwischen dem Wafer und dem Chipträgerverbund beteiligt zu sein, lediglich zur Erzielung und mechanischen Stabilisierung der Relativpositionierung in Eingriff mit der Trägerschicht des Chipträgerverbunds gelangen. Um nicht nur eine Starrkörperorientierung zwischen dem Wafer und dem Chipträgerverbund zu definieren, kann es sich als zweckmäßig erweisen, mehr als zwei Positionierungsstifte und eine entsprechende Anzahl von Positionierungsöffnungen vorzusehen, so daß Dehnungsbegrenzungen für beispielsweise thermisch bedingte Dehnungen in der Trägerschicht geschaffen werden.

[0027] Eine Alternative bezüglich einer vorteilhaften Vorgehensweise zur Herstellung eines Modulverbunds ist durch die folgenden Verfahrensschritte definiert:

[0028] Zunächst erfolgt wieder die Bereitstellung eines Wafers und eines Chipträgerverbunds mit einer Vielzahl von auf einer gemeinsamen Trägerschicht angeordneten Leiterbahnstrukturen mit Leiterbahnen, wobei bei dieser Verfahrensvariante ein Chipträgerverbund mit einer Trägerschicht verwendet wird, die Öffnungen aufweist, welche die Rückseite des Chipkontaktbereichs der Leiterbahnen und gegebenenfalls daran angrenzende Umgebungsbereiche freigeben. Anschließend erfolgt der Auftrag eines fließfähigen Füllmaterials, das, wie bei der vorstehend geschilderten Verfahrensvariante als ein Epoxyd-Kleber ausgebildet sein kann, auf die Kontaktoberfläche des Wafers oder die Chipkontaktseite des Chipträgerverbunds, derart, daß die Anschlußflächen des Wafers oder hierauf aufgebraute Kontaktmetallisierungen bzw. die Öffnungen der Trägerschicht freibleiben. Hierauf erfolgt die Relativpositionierung des Wafers und des Chipträgerverbunds, derart, daß sich eine Überdeckungslage zwischen den Anschlußflächen des Wafers bzw. darauf aufgebauten Kontaktmetallisierungen und den Öffnungen in der Trägerschicht des Chipträgerverbunds einstellt. Anschließend erfolgt eine flächige Verbindung zwischen dem Wafer und dem Chipträgerverbund und eine Kontaktierung der Anschlußflächen des Wafers bzw. der darauf angeordneten Kontaktmetallisierungen mit den Chipkontaktbereichen der zugeordneten Leiterbahnen durch Einbringung von Verbindungsmaterial in die Öffnungen der Trägerschicht des Chipträgerverbunds.

[0029] Die vorstehend erörterte Verfahrensvariante ermöglicht die Herstellung von eingangs erörterten er-

findungsgemäßen Chipmodulen, bei denen sowohl die Verbindungsmaterialdepots in den Ausnehmungen der Trägerschicht, die zur Kontaktierung des Chipmoduls mit anderen Bauteilen dienen, als auch das Verbindungsmaterial in den Öffnungen in der Trägerschicht zur Ermöglichung einer Kontaktierung zwischen den Leiterbahnen der Leiterbahnstruktur und den Chipanschlußflächen in einem Arbeitsgang eingebracht werden können.

[0030] Eine weitere Alternative ist durch ein Verfahren gemäß Anspruch 17 gegeben.

[0031] Die Kontaktierung kann durch Abscheidung von Verbindungsmaterial in den Öffnungen der Trägerschicht erfolgen, wobei sich in Versuchen besonders eine stromlose, also autokatalytische Abscheidung von Verbindungsmaterial durch Einbringung des Modulverbunds in ein entsprechendes Materialbad als vorteilhaft erwiesen hat. Bei diesem Materialbad kann es sich beispielsweise um ein Nickel-, Kupfer oder Palladiumbad handeln.

[0032] Die Kontaktierung kann auch durch Einbringung von Lotmaterial oder leitfähigem Kleber in die Öffnungen der Trägerschicht erfolgen, wobei hier alle bekannten Techniken zur Einbringung von Lotmaterial, also beispielsweise eine Schablonenbelotung oder auch eine Einbringung von stückigem Lotmaterial, eingesetzt werden können.

[0033] Gleichzeitig mit der Einbringung des Verbindungsmaterials in die Kontaktöffnungen der Trägerschicht kann eine Einbringung des Verbindungsmaterials in die Ausnehmungen der Trägerschicht erfolgen.

[0034] Unabhängig von der Art und Weise der Herstellung des Modulverbunds erweist es sich als vorteilhaft, wenn der Wafer auf seiner Rückseite mit einer Deckschicht versehen ist, die als Oberflächenschutz und auch zur Erzielung einer mechanischen Stützwirkung eingesetzt werden kann. Zusammen mit der Trägerschicht des Chipträgerverbunds ergibt sich somit nach Vereinzelung der Chipmodule aus dem Modulverbund ein gekapseltes Chipmodul.

[0035] Zur Erzeugung dieser Deckschicht hat sich ein Auftrag von Epoxyd-Material auf die Rückseite des Wafers als geeignet erwiesen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zur Ausbildung der Deckschicht eine Folie auf die Rückseite des Wafers aufzubringen. Die Folie kann mit einer Beschriftung, beispielsweise zur Kennzeichnung einzelner Chips des Wafers, versehen sein.

[0036] Unabhängig von der Art und Weise der Herstellung des Modulverbunds erfolgt nach dessen Fertigstellung eine Vereinzelung von Chipmodulen aus dem Modulverbund durch Trennung aneinander angrenzender Chipmodule längs definierter Trennlinien. In diesem Zusammenhang erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn hierzu das ohnehin zur Vereinzelung von Chips aus einem Waferverbund eingesetzte Sägeverfahren durchgeführt wird.

[0037] Vor der Vereinzelung der Chipmodule aus dem Modulverbund kann eine hinsichtlich des Aufwands und

der damit verbundenen Kosten besonders günstige elektrische Überprüfung der noch im Waferverbund angeordneten Chips über die Leiterbahnstrukturen des Chipträgerverbunds erfolgen.

5 [0038] Eine besonders gleichmäßige Form des Andrückens zur Herstellung der Verbindung zwischen dem Chipträger bzw. dem Chipträgerverbund und dem Chip bzw. dem Wafer wird erreicht, wenn das aneinander Andrücken der Chipträger bzw. des Chipträgerverbunds und der Chipoberfläche bzw. der Waferoberfläche mit-
10 tels Vakuum erfolgt. Bei genügend steif ausgebildeter Folie oder auch durch Aufbringen einer Zugspannung in Folienlängsrichtung gegen Durchbiegung stabilisierter Folie kann es auch ausreichend sein, das Andrücken des Chipträgers allein durch die zur Energiebeaufschlagung des Chipträgers bzw. des Chipträgerverbunds ver-
15 wendete Verbindungseinrichtung auszuführen. In diesem Fall dient der zur Verbindung der Leiterbahnen mit den Chipanschlußflächen erforderliche Anpressdruck gleichzeitig zum Andrücken des Chipträgers bzw. des Chipträgerverbunds gegen die Chipoberfläche bzw. die Waferoberfläche.

[0039] Zur Erzeugung von Lotbumps auf dem Chipträger bzw. dem Chipträgerverbund, die zur Verbindung des Chipmoduls mit einem Substrat, einer Platine oder dergleichen dienen, können die Außenkontaktbereiche des Chipträgers bzw. des Chipträgerverbunds in einem Schablonenauftragsverfahren mit Lotmaterial versehen werden, wobei die Trägerschicht selbst in einem nach-
20 folgenden Umschmelzverfahren als Lötstopmaske dient. Hierdurch wird die Erzeugung der Lotbumps auf besonders einfache Art und Weise möglich.

[0040] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Außenkontaktbereiche in einem Bestückungsverfahren mit Lotmaterialformstücken zu versehen, wobei in diesem Fall die durch die Ausnehmungen in der Trägerschicht gebildeten Außenkontaktbereiche als positio-
25 nierende Aufnahmen für das Lotmaterial dienen.

[0041] Zur Verbindung zwischen den Kontaktmetallisierungen des Chips bzw. des Wafers und den Leiterbahnen des Chipträgers bzw. des Chipträgerverbunds können unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden, deren gemeinsames Merkmal darin besteht, daß bei einer rückwärtigen Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen unter Zwischenlage der Trägerschicht die Trägerschicht im wesentlichen unversehrt und geschlos-
30 sen bleibt. Als besonders geeignete Verfahren erscheinen in diesem Zusammenhang Lötverfahren und Thermokompressionsverfahren, die mittels einer rückwärtigen Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen mit Laserstrahlung durchgeführt werden, wobei die Laserstrahlung durch eine rückwärtig unter Druck an der Trägerschicht anliegende Lichtleitfaser eingeleitet wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Ultraschall-
35 verfahren einzusetzen, bei dem ein Ultraschallstempel rückwärtig auf die Trägerschicht aufgesetzt wird und durch die im Bereich der Verbindungsstelle komprimierte Trägerschicht Ultraschallschwingungen in die Verbin-

dungsstelle zwischen der betreffenden Leiterbahn und der Chipanschlußfläche einbringt.

[0042] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Chipmoduls sowie ein mögliches Verfahren zur Herstellung eines derartigen Chipmoduls unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1** ein Ausführungsbeispiel eines Chipmoduls mit einem auf einem Chip kontaktierten Chipträger;
- Fig. 2 bis 6** den Aufbau eines Chipträgers;
- Fig. 7** den Chipträger und den Chip unmittelbar vor Herstellung des Chipmoduls;
- Fig. 8** den Chipträger und den Chip während der Herstellung der Verbindung zwischen dem Chipträger und dem Chip;
- Fig. 9** die Herstellung eines längs der Peripherie des Chips verlaufenden Dicht- bzw. Stützrahmens;
- Fig. 10** einen den Chip einschließenden Verguß;
- Fig. 11** die nachträgliche Applikation von Lotmaterial auf dem Chipträger;
- Fig. 12 bis 14** mehrere Beispiele für flächig verteilte Anschlußflächenanordnungen auf dem Chipträger verschiedener Chipmodule;
- Fig. 15** einen Modulverbund aus einem Wafer und einem darauf angeordneten Chipträgerverbund in Draufsicht;
- Fig. 16** eine vergrößerte Einzeldarstellung eines Chipträgers aus dem in **Fig. 15** dargestellten Chipträgerverbund;
- Fig. 17** eine Einzeldarstellung eines Verbindungsaufbaus zwischen einer Außenanschlußfläche eines Chipträgers und einer Chipanschlußfläche eines Chips in Draufsicht;
- Fig. 18** den in **Fig. 17** dargestellten Verbindungsaufbau in einer Seitenansicht vor der Applikation von Verbindungsmaterial;
- Fig. 19** eine in der Ansicht **Fig. 18** entsprechende Darstellung des Verbindungsaufbaus nach der Applikation von Ver-

bindungsmaterial;

Fig. 20 eine Schnittansicht der Verbindung zwischen einer Leiterbahn des Chipträgers und der Chipanschlußfläche gemäß dem Schnittlinienverlauf XX-XX in **Fig. 19**.

[0043] **Fig. 1** zeigt ein Chipmodul 20 mit einem Chipträger 21, der auf einem Chip 22 kontaktiert ist. Das in **Fig. 1** dargestellte Chipmodul 20 wird auch als Chip-Size-Package (CSP) bezeichnet, da die wesentlichen Abmessungen des Chipmoduls 20 durch den Chip 22 bestimmt sind. Als Definitionsgröße für ein CSP gilt in der Fachwelt allgemein ein Verhältnis von 0,8 bis 1,2 zwischen der Chipoberfläche und der Oberfläche des Chipträgers.

[0044] Bei dem in **Fig. 1** dargestellten Chipmodul 20 wird ein Chipträger 21 aus einer dreilagigen Folie verwendet mit einer Trägerschicht 23 aus Polyimid und einer als Leiterbahnstruktur 24 ausgebildeten Kontaktschicht aus Kupfer, die hier über eine Kleberschicht 25 mit der Trägerschicht 23 verbunden ist. Die Trägerschicht 23 ist mit Ausnehmungen 26 versehen, die sich von der Oberfläche der Trägerschicht 23 bis zu einer Rückseite 27 von der Leiterbahnstruktur 24 bildenden einzelnen Leiterbahnen 28 erstreckt. Diese Ausnehmungen 26 bilden Außenkontaktbereiche, die mit Lotmaterialdepots 29 zur Kontaktierung mit Anschlußflächen 30 eines in **Fig. 1** mit strichpunktiertem Linienverlauf angedeutetem Substrats 31 dienen.

[0045] **Fig. 1** zeigt beispielhaft zwei von einer Vielzahl peripher auf der Chipoberfläche angeordneten Chipanschlußflächen 32, die mit Kontaktmetallisierungen 33 versehen sind. Die Kontaktmetallisierungen sind mit jeweils zugeordneten Leiterbahnen 28 kontaktiert, so daß durch die Leiterbahnen 28 eine "Umverdrahtung" der peripher auf der Chipoberfläche angeordneten Chipanschlußflächen 32 in eine flächig verteilte, hinsichtlich des Abstandes zwischen den einzelnen Anschlußflächen aufgeweitete Anschlußflächenanordnung 34 auf der Oberfläche des Chipträgers 21 erfolgt. Zur abdichtenden Verbindung des Chipträgers 21 mit dem Chip 22 und zur mechanischen Stabilisierung des als flexible Folie ausgebildeten Chipträgers 21 ist in einem zwischen einer Chipkontaktseite 35 und der Chipoberfläche ausgebildeten Spalt 36 ein Füllmaterial 37 mit Haft- oder Klebewirkung vorgesehen, das fachsprachlich auch als "Underfiller" bezeichnet wird.

[0046] In den **Fig. 2 bis 6** ist in chronologischer Abfolge die Herstellung des in **Fig. 1** zur Erzeugung der Chipträger-Anordnung 20 verwendeten Chipträgers 21 erläutert. Wie **Fig. 2** zeigt, ist Basis bei der Herstellung des Chipträgers 21 eine dreilagige Folie 38 mit einer die Trägerschicht 23 mit der Leiterbahnstruktur 24 verbindenden Kleberschicht 25. In einer vereinfachten Ausführung ist es jedoch auch möglich, eine mit dem Chipträger 21 vergleichbare Ausführung eines Chipträgers,

ausgehend von einer Folie, zu schaffen, bei der die Leiterbahnstruktur unmittelbar auf der Trägerschicht, also ohne zwischenliegende Anordnung einer Kleberschicht, angeordnet ist.

[0047] Die Folie 38, die als Endlosfolie ausgebildet sein kann, weist in jedem Fall die in der Trägerschicht 23 vorgesehenen, bis zur Rückseite 27 der Leiterbahnen 28 reichenden Ausnehmungen 26 auf, wobei die Ausnehmungen beispielsweise durch geeignete Ätzverfahren oder auch durch Laserablation erzeugt werden können.

[0048] Für den Fall, daß in den Ausnehmungen 26 mittels eines Schablonenauftragsverfahrens Lotmaterial 42 zur Erzeugung der Lotmaterialdepots 29 (Fig. 1 und 6) eingebracht werden soll, kann, wie in Fig. 3 dargestellt, eine Schablone 39 auf die Trägerschicht 23 aufgelegt werden, und zwar so, daß in der Schablone 39 vorgesehene Schablonenöffnungen 40 dekkungsgleich mit den Ausnehmungen 26 in der Trägerschicht 23 zu liegen kommen.

[0049] In die aus den übereinanderliegend angeordneten Ausnehmungen 26 und Schablonenöffnungen 40 gebildeten Lotmaterialaufnahmen 41 wird nach flächigem Auftrag des Lotmaterials 42 auf die Oberfläche der Schablone 39 durch einen hier nicht näher dargestellten Rakel oder dergleichen eine Befüllung der Lotmaterialaufnahmen 41 mit Lotmaterial 42 in der in Fig. 4 dargestellten Art und Weise erzielt.

[0050] Wie in Fig. 5 dargestellt, verbleiben nach Abnahme der Schablone 39 von der Trägerschicht 23 beispielsweise aus pastösem Lotmaterial gebildete Lotmaterialmengen 68 in den Ausnehmungen 26. Durch ein nachfolgendes Umschmelzverfahren werden dann die in Fig. 6 dargestellten meniskusartig geformten Lotmaterialdepots 29 erzeugt, wobei die Trägerschicht 23 während des Umschmelzens als Lötstopmaske dient.

[0051] Fig. 7 zeigt, wie ausgehend von dem entsprechenden den Erläuterungen zu den Fig. 2 bis 6 erzeugten Chipträger 21 das in Fig. 1 dargestellte Chipmodul 20 gebildet wird. Hierzu erfolgt ein Auftrag einer definierten Füllmaterialmenge 43 auf die Chipoberfläche und eine dem gewählten Verfahren zur Verbindung der Kontaktmetallisierungen 33 des Chips mit den Leiterbahnen 28 des Chipträgers 21 entsprechende Präparierung der im Ausgangszustand aus Aluminium bestehenden Chipanschlußflächen 32. Im vorliegenden Fall sind die Chipanschlußflächen 32 mit als Nickelbumps ausgebildeten Kontaktmetallisierungen 33 mit einem Lotüberzug 44 aus einer Gold/Zinn-Legierung versehen, um die Kontaktierung der Leiterbahnen 28 des Chipträgers 21 mit den Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 in einem nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 8 noch näher erläuterten Lötverfahren durchführen zu können.

[0052] Dabei kann der Gold/Zinn-Lotüberzug 44 durch einfaches Eintauchen der Kontaktmetallisierungen 33 in eine entsprechend flüssig ausgebildete Legierung aufgebracht werden.

[0053] Zur Herstellung des Chipmoduls 20 (Fig. 1),

also des festen mechanischen Verbunds zwischen dem Chipträger 21 und dem Chip 22, wird nun der Chipträger 21 gegen die Oberfläche des Chips 22 gedrückt, so daß die auf die Chipoberfläche aufgebrauchte Füllmaterialmenge 43 bei Ausbildung des Spaltes 36 zwischen der Chipkontaktseite 35 des Chipträgers 21 und der Chipoberfläche nach außen zur Peripherie des Chips 22 verdrängt wird und sich gleichmäßig auf der Chipoberfläche bis hin zu Außenrändern 45 des Chips 22 verteilt.

[0054] Fig. 8 zeigt, daß dieses Andrücken des Chipträgers 21, der sich in der Darstellung gemäß Fig. 8 noch im endlosen Folienverbund befindet, mittels einer Vakuumeinrichtung 46 ausgeführt werden kann, bei der der Chip 22 in einer Chipaufnahme 47 fixiert ist und der Chipträger 21 über einen die Chipaufnahme 47 umgebenden Ringkanal 48 durch Vakuumwirkung (Pfeil 50) gegen die Chipoberfläche gesogen wird. Dabei ist in Fig. 8 deutlich zu erkennen, daß aufgrund des Kapillareffekts im Spalt 36 zwischen dem Chipträger 21 und dem Chip 22 eine Verteilung des Füllmaterials 37 über die Außenränder 45 des Chips 22 hinaus erfolgt, so daß sich im Bereich eines möglichen Überstands 49 des Chipträgers 21 über die Oberfläche des Chips 22 eine zusätzlich abstützende Wirkung ergibt.

[0055] Wie ebenfalls in Fig. 8 dargestellt, kann zur Fixierung des Chips 22 in der Chipaufnahme 47 ebenfalls, wie durch den Pfeil 50 angedeutet, Vakuumwirkung eingesetzt werden. Um zu verhindern, daß es aufgrund des Austritts von Füllmaterial 37 aus dem Spalt 36 im Bereich des Überstands 49 zu Verklebungen mit der Innenwand der Chipaufnahme 47 kommt, ist die Innenwand der Chipaufnahme 47 mit einer Antihafbeschichtung 51 versehen.

[0056] Wie aus Fig. 8 ferner zu ersehen ist, wird zur Verbindung der Leiterbahnen 28 des Chipträgers 21 mit den Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 die Trägerschicht 23 des Chipträgers 21 über eine Lichtleitfaser 52 unter gleichzeitiger Aufbringung eines Anpreßdrucks mit Laserstrahlung 53 beaufschlagt. Die Laserstrahlung 53 durchdringt das optisch durchlässige Polyimid der Trägerschicht 23 oder einen anderen für Laserstrahlung optisch durchlässigen, als Trägerschicht verwendeten Kunststoff und wird im Bereich der Leiterbahn 28 absorbiert, so daß im Bereich der Verbindungsstelle zwischen der Leiterbahn 28 und der zugeordneten Kontaktmetallisierung 33 die für die thermische Verbindung notwendige Temperatur induziert wird. Dabei wird durch den mit der Lichtleitfaser 52 auf die Trägerschicht 23 aufgebrauchten Anpreßdruck möglicherweise zwischen der Leiterbahn 28 und der Kontaktmetallisierung 33 bzw. dem auf die Kontaktmetallisierung 33 aufgebrauchten Lotüberzug 24 angeordnetes Füllmaterial 37 verdrängt, so daß die Verbindung nicht durch Füllmaterial 37 beeinträchtigt werden kann.

[0057] Falls es zur Erzielung einer planen Oberfläche des auf den Chip 22 applizierten Chipträgers 21 notwendig sein sollte, kann noch ein in Fig. 8 nicht näher dargestelltes zentrales Stempelwerkzeug zur Erzeugung

einer ebenen Anlage des Chipträgers 21 eingesetzt werden.

[0058] Neben der vorstehend geschilderten Verbindung der Leiterbahnen 28 des Chipträgers 21 mit den Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 im Lötverfahren ist es auch möglich, das in **Fig. 8** dargestellten Verbindungsmittel, also die durch Laserenergie beaufschlagte Lichtleitfaser 52, zur Ausführung einer Thermokompressionsverbindung zu verwenden, zu deren Vorbereitung die als Nickelbumps ausgeführten Kontaktmetallisierungen 33 nicht mit dem Lotüberzug 44, sondern mit einem dünnen Goldüberzug versehen werden.

[0059] Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung der Verbindung zwischen den Leiterbahnen 28 des Chipträgers 21 und den Kontaktmetallisierungen 33 bzw. unmittelbar mit den unpräparierten Aluminiumanschlußflächen 32 des Chips 22 besteht darin, anstatt der in **Fig. 8** dargestellten Lichtleitfaser 52 einen Ultraschallhorn zu verwenden, der mit Ultraschall beaufschlagt wird und die Ultraschallschwingungen über einen verdichteten Bereich der Trägerschicht 23 auf den Verbindungsbe-
reich zwischen den Leiterbahnen 28 und den jeweils zugeordneten Chipanschlußflächen 32 überträgt.

[0060] Die **Fig. 9** und **10** zeigen Möglichkeiten einer neben der Anordnung des Füllmaterials 37 im Spalt 36 zwischen dem Chipträger 21 und dem Chip 22 (Underfilling) zusätzlichen mechanischen Stabilisierung des Chipmoduls. Wie **Fig. 9** zeigt, kann hierzu im peripheren Bereich längs des Umfangsrandes des Chips 22 im Übergang zum Chipträger 21 zusätzliches Füllmaterial 37 zur Ausbildung eines umlaufenden Stabilisierungsrahmens aufgebracht werden.

[0061] **Fig. 10** zeigt ein als "Molding" bekanntes Verfahren, bei dem der Chip mittels einer Kunststoffmasse 55 umkapselt wird.

[0062] Sowohl die Kunststoffmasse 55 als auch das gemäß **Fig. 9** zusätzlich applizierte Füllmaterial 37 sorgen im Bereich des Überstands 49 des Chipträgers 21 über die Oberfläche des Chips 22 für eine stabilisierende Abstützung. Da sich bei den in den **Fig. 9** und **10** dargestellten Verfahren zur zusätzlichen Stabilisierung der Chipträger-Anordnung, bei denen die Chipträger-Folie 38 auf einer ebenen Fläche durch eine Vakuumeinrichtung 56 gehalten wird, vorstehende Lotmaterialdepots 29, wie in **Fig. 1** dargestellt, als störend erweisen würden, werden in diesen Fällen die Lotmaterialdepots 29 erst nachträglich erzeugt. Hierzu können, wie in **Fig. 11** dargestellt, Lotmaterialformstücke 57 vor oder nach Heraustrennen der mit dem Chip 22 verbundenen Chipträger 21 aus der Chipträger-Folie 38 in die Ausnehmungen 26 plaziert und anschließend zur Ausbildung der Lotmaterialdepots 29 umgeschmolzen werden. Bei dem in **Fig. 11** dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Lotmaterialformstücke 57 kugelförmig ausgebildet und werden durch eine Lotkugelplaziereinrichtung 58 in die Ausnehmungen 26 plaziert.

[0063] In den **Fig. 12, 13** und **14** sind unterschiedlich

ausgebildete Chipmodule 59, 60 und 61 beispielhaft dargestellt. Dabei entspricht die gewählte Ansicht in etwa einem Schnittverlauf zwischen der Trägerschicht 23 und jeweils einer die Leiterbahnen 28 aufweisenden Kontaktschicht 69, 70, 71. **Fig. 12** zeigt das Chipmodul 59 mit einer sogenannten "zweireihigen Fan-Out"-Konfiguration, bei der ausgehend von der peripheren, einreihigen Anordnung der Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 über die Kontaktschicht 69 eine flächige Umverteilung in einem Chipträger 62 erfolgt, bei der außerhalb der Chipperipherie zwei Reihen 63, 64 von Außenkontaktbereichen 26 angeordnet sind.

[0064] **Fig. 13** zeigt eine übereinstimmende Konfiguration, wobei hier ein Chipträger 65 verwendet wird, bei dessen Kontaktschicht 70 nicht nur die Leiterbahnen 28 aus Kupfer, sondern vielmehr die gesamte Kontaktschicht 70 aus Kupfer besteht, wobei die Leiterbahn 28 durch Ätzfugen vom übrigen Kupfermaterial getrennt ist. Der in **Fig. 13** beispielhaft dargestellte Chipträger 65 zeichnet sich daher durch eine besonders hohe Steifigkeit aus.

[0065] **Fig. 14** zeigt schließlich einen Chipträger 66 mit einer sogenannten einreihigen "Fan-Out"-Konfiguration, bei der lediglich eine Reihe 67 von Außenkontaktbereichen 26 außerhalb der Chipperipherie angeordnet ist und alle übrigen Außenkontaktbereiche 26 sich innerhalb der Chipperipherie verteilt befinden.

[0066] **Fig. 15** zeigt einen Modulverbund 72 mit einem Wafer 73 und einem auf dem Wafer 73 angeordneten Chipträgerverbund 74 mit einer Vielzahl zusammenhängend auf der gemeinsamen Trägerschicht 23 angeordneter Chipträger 76. Wie der Darstellung gemäß **Fig. 15** zu entnehmen ist, weist der Wafer eine Vielzahl zusammenhängend ausgebildeter Chips 75 auf, denen jeweils ein Chipträger 76 aus dem Chipträgerverbund 74 zugeordnet ist. Zu der der Herstellung des in **Fig. 15** dargestellten Modulverbunds 72 nachfolgenden Vereinzelung von Chipmodulen 77, die im vorliegenden Fall aus jeweils einem Chip 75 und einem Chipträger 76 gebildet sind, sind auf dem Wafer 73 Teilungsnuten 78 vorgesehen, längs deren Verlauf der Modulverbund 72 durch Sägen oder auch andere geeignete Trennvorgänge in die Chipmodule 77 vereinzelt werden kann.

[0067] Die aus dem Modulverbund 72 vereinzelt Chipmodule 77 können in einer Ausführungsform hinsichtlich ihres Aufbaus im wesentlichen mit dem in **Fig. 1** dargestellten Chipmodul 20 übereinstimmen, mit dem Unterschied, daß der Chipträger 76 abweichend von dem in **Fig. 1** dargestellten Chipträger 21 mit seinen Außenrändern im wesentlichen bündig mit den Chipseitenrändern verläuft und diese nicht, wie in **Fig. 1** dargestellt, seitlich überragt.

[0068] Ein derartiger Chipträger 76 ist in Draufsicht in **Fig. 16** dargestellt und ermöglicht, ausgehend von den Chipkontaktbereichen 81, eine sogenannte "Fan-In"-Verteilung von Anschlußflächen 79 einer Anschlußflächenanordnung 80 auf der Trägerschicht 23 des Chipträgers 76. Die Anschlußflächenanordnung 80 des

Chipträgers 76 ist in **Fig. 15** durch einen rahmenartigen, schraffierten Linienverlauf vereinfacht dargestellt.

[0069] Abgesehen von dem vorstehend erwähnten Unterschied zum Aufbau des in **Fig. 1** dargestellten Chipmoduls 20, derart, daß zur Herstellung eines Chipmoduls 77 eine im wesentlichen zu der Chipoberfläche bündige Ausbildung des Chipträgers 76 erforderlich ist, können zur Herstellung des in **Fig. 15** dargestellten Modulverbunds sämtliche der in den **Fig. 2 bis 7** dargestellten Verfahrensschritte durchgeführt werden, mit dem Unterschied, daß statt eines einzelnen Chips 22 eine Vielzahl in dem Wafer 73 zusammenhängend ausgebildeter Chips 75 und statt eines einzelnen Chipträgers 21 eine Vielzahl in dem Chipträgerverbund 74 zusammenhängend ausgebildeter Chipträger 76 verwendet werden. Es erfolgt somit die Herstellung von Chipmodulen 77 durch Vereinzelung der Chipmodule 77 aus einem zuvor beispielsweise entsprechend den in den **Fig. 2 bis 7** dargestellten Verfahrensschritten hergestellten Modulverbund 72.

[0070] Um bei der großflächigen Applikation des Chipträgerverbunds 74 auf dem Wafer 73 - wie beispielsweise bezogen auf die Herstellung des einzelnen Chipmoduls 20 in **Fig. 7** dargestellt - die Ausbildung von Lufteinschlüssen zwischen dem Chipträgerverbund und der Oberfläche des Wafers 73 zu verhindern, kann der Chipträgerverbund mit in **Fig. 15** nicht näher dargestellten, als Perforationslinien ausgebildeten Teilungslinien versehen sein, die deckungsgleich mit den Teilungslinien 78 des Wafers 73 sind, die einzelnen Chipträger 76 voneinander abteilen und gleichzeitig durch die Perforationen ein Entweichen von Luft zur Verhinderung der vorstehend erwähnten Lufteinschlüsse ermöglichen.

[0071] Zur Ermöglichung einer korrekten Relativpositionierung des Chipträgerverbunds 74 zum Wafer 73 mit entsprechenden, in **Fig. 15** dargestellten Überdeckungen zwischen den einzelnen Chipträgern 76 und den Chips 75, die eine Kontaktierung zwischen den Chipkontaktbereichen 81 an den Enden von Leiterbahnen 82 von den einzelnen Chipträgern 76 zugeordneten Leiterbahnstrukturen 83 ermöglichen, kann der Wafer 73 auf seiner Oberfläche mit Positionierungsstiften 84, 85 versehen sein, die in korrespondierend ausgebildete, hier nicht näher dargestellte Positionierungsöffnungen in der Trägerschicht 23 des Chipträgerverbunds 74 eingreifen. Die Positionierungsstifte 84, 85 können von überhöht ausgebildeten Bumps im Randbereich des Wafers 73 unvollständig ausgebildeter Chips gebildet sein. Wie die übrigen, hier nicht näher dargestellten Bumps der funktionsfähigen Chips 75 können grundsätzlich die Bumps des Wafers durch beispielsweise autokatalytische Materialabscheidung oder eine Tauchbelegung hergestellt werden.

[0072] In den **Fig. 17 bis 20** ist eine von der in den **Fig. 2 bis 7** abweichende Herstellung des Verbundes zwischen einem Chip und einem Chipträger bzw. einem Wafer und einem Chipträgerverbund am Beispiel der Verbindung einer Chipanschlußfläche 86 mit einer Lei-

terbahn 82 eines Chipträgers 76 dargestellt. Wie nachfolgend erläutert wird, ermöglicht der in den **Fig. 17 bis 20** dargestellte Verbindungsaufbau eine besonders kostengünstige Herstellung von Chipmodulen 77 auf Waferebene (**Fig. 15**).

[0073] Wie die Draufsicht auf einen ausgeschnittenen Bereich des Chipträgers 76 in **Fig. 17** in einer Zusammenschau mit der entsprechenden Seitenansicht in **Fig. 18** deutlich macht, besteht der Chipträger 76 im vorliegenden Fall aus der Trägerschicht 23 mit einer auf deren Unterseite angeordneten Leiterbahnstruktur 83, von der hier lediglich die eine Leiterbahn 82 dargestellt ist. Die Leiterbahn 82 ist im vorliegenden Fall aus einem Stableiter 87 und einem Kreisflächenleiter 88 zusammengesetzt. Die Leiterbahn 82 ist so auf der Unterseite der Trägerschicht 23 angeordnet, daß sich ein Chipkontaktbereich 89 des Stableiters 87 und der Kreisflächenleiter 88 der Leiterbahn 82 unterhalb einer Öffnung 90 bzw. einer Ausnehmung 91 in der Trägerschicht 23 befinden. Die Ausnehmung 91 ist nach unten durch die Rückseite des Kreisflächenleiters 88 der Leiterbahn 82 begrenzt. Die Öffnung 90 in der Trägerschicht 23 reicht bis an die Rückseite des Stableiters 87 der Leiterbahn 82 und gibt überdies einen den Chipkontaktbereich 89 des Stableiters 87 umgebenden Umgebungsbereich 92 frei, der, wie in **Fig. 17** dargestellt, sich noch über die Chipanschlußfläche 86 hinaus erstreckt.

[0074] Wie **Fig. 18** zeigt, ist eine zur Herstellung des Verbunds zwischen dem Chipträgerverbund 74 und dem Wafer 73 vorgesehene Kleberschicht 98 so angeordnet, daß eine im wesentlichen mit der Fläche der Öffnung 90 deckungsgleiche Verbindungsfläche 93 auf der Oberfläche des Wafers 73 bzw. des Chips 75 ausgebildet ist, in deren Innenbereich die Chipanschlußfläche 86 angeordnet ist. Weiterhin wird aus **Fig. 18** deutlich, daß zwischen der Oberfläche der Chipanschlußfläche 86 und der Unterseite des Stableiters 87 der Leiterbahn 82 ein Kontaktpalt 94 ausgebildet ist.

[0075] **Fig. 19** zeigt die Ausnehmung 91 im Chipträger 76 des Chipträgerverbunds 74 und die im Umgebungsbereich 92 bis an die Oberfläche des Wafers 73 reichende Öffnung 90 des Chipträgers 76 nach Einbringung eines Verbindungsmaterials 95. Dabei ist die Öffnung 90 im Bereich der Chipanschlußfläche 86 und des Chipkontaktbereichs 89 der Leiterbahn 82 sowie der Kontaktpalt 94 mit dem Verbindungsmaterial 95 ausgefüllt, so daß, wie aus der Schnittdarstellung in **Fig. 20** deutlich wird, ein allseitiger Einschluß der Leiterbahn 82 im Chipkontaktbereich 89 mit sicherer Verbindung zur Chipanschlußfläche 86 die Folge ist. Dieser allseitige Einschluß ist eine Folge des allseitigen Aufwachsens des Verbindungsmaterials 95 beim Abscheidevorgang. Hieraus ergibt sich auch ein Zuwachsen des Kontaktpalts 94.

[0076] Als besonderer Vorteil bei dem in den **Fig. 17 bis 20** dargestellten Verbindungsaufbau erweist es sich, daß sowohl die Ausnehmung 91 als auch die Öffnung 90 im Chipträger 76 in ein und demselben Verfahrens-

schritt mit Verbindungsmaterial 95 befüllt werden können, so daß einerseits Außenkontaktbumps 96 für die äußere Anschlußflächenanordnung 80 des Chipträgers 76 und andererseits Innenverbindungen 97 zwischen dem Wafer 73 bzw. den durch diesen zusammenhängend ausgebildeten Chips 75 und den Chipträgern 76 geschaffen werden.

[0077] Die Öffnungen 90 im Chipträgerverbund 74 sind ausreichend groß, so daß die Chipanschlußflächen 86 des Wafers 73 vor der Einbringung von Verbindungsmaterial 95, die beispielsweise durch autokatalytische Abscheidung von Nickel oder dergleichen erfolgen kann, gereinigt und/oder mit einer Beschichtung, beispielsweise Zinkat oder einer Nickel-Zwischenschicht, versehen werden können.

[0078] Die Einbringung des Verbindungsmaterials kann auf besonders vorteilhafte Weise durch Eintauchen des Wafers 73 oder Hindurchführen des Wafers 73 in bzw. durch ein Materialbad erfolgen.

[0079] Abweichend von der in den Fig. 17 bis 20 dargestellten stabförmigen Geometrie der Leiterbahn 82 im Bereich der Öffnung 90 sind auch andere Leiterbahngeometrien möglich, die in besonderer Weise das vorgeschriebene Aufwachsen des Verbindungsmaterials beim Abscheidevorgang zur Ausbildung der Verbindung zwischen dem Chipanschluß 86 und der Leiterbahn 82 fördern und nutzen. So kann die Leiterbahn 82 einen ringförmig ausgebildeten Chipkontaktbereich aufweisen, dessen Innendurchmesser so bemessen ist, daß der Verbindungsmaterialaufbau auf der Chipanschlußfläche 86 infolge des Abscheidevorgangs quasi durch den Ring hindurch wächst und so zur Ausbildung der Verbindung beiträgt. Dabei kann der ringförmig ausgebildete Chipkontaktbereich durch den Rand der Öffnung 90 abgedeckt sein oder offenliegen. Insbesondere bei einem durch den Rand der Öffnung 90 in der Trägerschicht 23 abgedeckten ringförmigen Chipkontaktbereich läßt sich eine im wesentlichen zur Oberfläche des Chipträgers 76 bzw. des Chipträgerverbunds 74 bündig ausgebildete Oberfläche der Innenverbindung erzielen, ohne daß hierzu besondere Maßnahmen notwendig wären. Grundsätzlich kann die Öffnung 90 größer oder kleiner als die Chipanschlußfläche, aber auch gleich groß ausgebildet sein.

[0080] Weitere Möglichkeiten, die Ausbildung der Oberfläche der Innenverbindung durch die Gestaltung der Leiterbahn 82 in deren Chipkontaktbereich 89 über die Geometrie der Leiterbahn 82 zu beeinflussen, bestehen darin, die Leiterbahn 82 in diesem Bereich rahmenartig quadratisch, schlitzförmig oder auch kreuzartig auszubilden.

Patentansprüche

1. Chipmodul mit einem Chipträger (21) und mindestens einem Chip (22, 75), wobei der Chipträger als Folie ausgebildet ist mit einer Trägerschicht (23)

aus Kunststoff und einer Leiterbahnstruktur mit Leiterbahnen (28), wobei die Leiterbahnen auf ihrer Vorderseite mit Anschlußflächen (32) des Chips verbunden sind und auf ihrer Rückseite Außenkontaktbereiche zur Ausbildung einer flächig verteilten Anschlußflächenanordnung zur Verbindung des Chipmoduls mit einem elektronischen Bauelement oder einem Substrat aufweisen, wobei die Leiterbahnen in einer Ebene auf der dem Chip zugewandten Chipkontaktseite der Trägerschicht verlaufen und die Außenkontaktbereiche durch Ausnehmungen in der Trägerschicht gebildet sind, die sich gegen die Rückseite der Leiterbahnen erstrecken **dadurch gekennzeichnet,** daß sich die Trägerschicht (23) über die Chipoberfläche des Chips (22, 75) erstreckt, der Chipträger (21) unter zwischenliegender Anordnung eines Füllstoffs (37) mit dem Chip (22, 75) verbunden ist, und die Trägerschicht (23) sich über den Bereich der Anschlußflächen (32) des Chips (22, 75) erstreckt.

2. Chipmodul nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Trägerschicht (23) über den Bereich der Anschlußflächen (32) des Chips hinweg kontinuierlich ausgebildet ist, derart, daß die Trägerschicht (23) im Bereich der Anschlußflächen (32) des Chips geschlossen ist.
3. Chipmodul nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Trägerschicht (23) in einem Überdeckungsbereich mit den Anschlußflächen (32, 86) des Chips (22, 75) Öffnungen (90) aufweist, die sich gegen die Rückseite (27) der Leiterbahnen (82) erstrecken und zur Aufnahme von die Leiterbahnen mit den zugeordneten Anschlußflächen elektrisch verbindendem Verbindungsmaterial (95) dienen.
4. Chipmodul nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Leiterbahnen (82) im Bereich der Öffnungen (90) so angeordnet sind, daß ein Chipkontaktbereich (89) der Leiterbahnen (82) die Anschlußflächen (32, 86) des Chips (22, 75) nur teilweise überdeckt, oder der Chipkontaktbereich (89) der Leiterbahnen (82) benachbart zu den Anschlußflächen (32) liegt.
5. Chipmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet,** daß längs der Peripherie des Chips (22) verlaufend ein Stützrahmen vorgesehen ist.
6. Chipmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4,

gekennzeichnet durch

einen die Seitenflächen des Chips (22) mit einem die Chipoberfläche überragenden Überstand (49) des Chipträgers (21) verbindenden Verguß.

7. Chipmodul nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Außenkontaktbereiche (26) mit Lotmaterial (42) versehen sind, dessen Schmelzpunkt niedriger ist als die zur thermischen Verbindung zwischen den Kontaktflächenmetallisierungen (33) des Chips (22) und den Leiterbahnen (28) des Chipträgers (21) notwendige Temperatur.
8. Modulverbund mit einer Chipträgeranordnung und einer Chipanordnung, insbesondere einem Wafer, mit einer Vielzahl zusammenhängend ausgebildeter Chipmodule nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, bei dem sowohl die Chipträger als auch Chips jeweils einen Verbund bilden.
9. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch
die Verfahrensschritte:
 - Auftragen eines fließfähigen Füllmaterials (37) auf die Chipoberfläche oder die Chipkontaktseite (35) des Chipträgers (21);
 - einander Andrücken einer Chipkontaktseite (35) des Chipträgers (21) und der Chipoberfläche und Kontaktierung der Leiterbahnen (28) des Chipträgers (21) mit den zugeordneten Kontaktmetallisierungen (33) des Chips (22) **durch** eine von der Seite der Trägerschicht, welche der Seite, die die Leiterbahnanordnung aufweist, gegenüberliegt, ausgehenden, rückwärtigen Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen (28) unter Zwischenlage der Trägerschicht (23) bei gleichzeitiger Verdrängung des Füllmaterials (37).
10. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch
die Verfahrensschritte:
 - Bereitstellung eines Chipträgers, der auf der dem Chip (22) zugewandten Chipkontaktseite (35) mit einer Kleberschicht versehen ist;
 - einander Andrücken der Chipkontaktseite (35) des Chipträgers (21) und der Chipoberfläche und Kontaktierung der Leiterbahnen (28) des Chipträgers (21) mit den zugeordneten Kontaktmetallisierungen (33) des Chips (22) **durch** eine rückwärtige Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen (28) unter Zwischenlage der Trä-

gerschicht (23) bei gleichzeitiger Verdrängung des Klebermaterials (37).

11. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch
die Verfahrensschritte:
 - Herstellung eines Modulverbunds (72) mit einem Chipträgerverbund (74) und einem Chipverbund (73) nach Anspruch 8;
 - Herstellung einer Mehrzahl einzelner Chipmodule (77) **durch** Vereinzelung von Einheiten aus mindestens einem Chip (75) und einem damit kontaktierten Chipträger (76) aus dem Modulverbund (73).
12. Verfahren nach Anspruch 11,
gekennzeichnet durch
die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung des Modulverbunds (72):
 - Bereitstellung eines Wafers (73), der auf den Anschlußflächen (86) mit erhöhten Kontaktmetallisierungen versehen ist, und eines Chipträgerverbunds (74) mit einer Vielzahl von auf einer gemeinsamen Trägerschicht (23) angeordneten Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen (82);
 - Auftragen eines fließfähigen Füllmaterials (37) auf die Kontaktfläche des Wafers oder die Chipkontaktseite des Chipträgerverbunds;
 - Relativpositionierung des Wafers und des Chipträgerverbunds, derart, daß sich eine Überdeckungslage zwischen den Kontaktmetallisierungen des Wafers und Kontaktbereichen (89) der zugeordneten Leiterbahnen (82) der Leiterbahnstrukturen einstellt;
 - Herstellung einer flächigen Verbindung zwischen dem Wafer und dem Chipträgerverbund und Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen des Wafers mit den zugeordneten Leiterbahnen des Chipträgerverbunds.
13. Verfahren nach Anspruch 11,
gekennzeichnet durch
die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung des Modulverbunds (72):
 - Bereitstellung eines Wafers (73), der auf den Anschlußflächen (86) mit erhöhten Kontaktmetallisierungen versehen ist, und eines Chipträgerverbunds (74) mit einer Vielzahl von auf einer gemeinsamen Trägerschicht (23) angeordneten Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen (82) und einer Kleberschicht (37) auf der Chipkontaktseite der Trägerschicht (23);
 - Relativpositionierung des Wafers (73) und des

- Chipträgerverbunds (74), derart, daß sich eine Überdeckungslage zwischen den Kontaktmetallisierungen des Wafers und Kontaktbereichen (89) der zugeordneten Leiterbahnen (82) der Leiterbahnstrukturen einstellt;
- Herstellung einer flächigen Verbindung zwischen dem Wafer (73) und dem Chipträgerverbund (74) und Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen des Wafers mit den zugeordneten Leiterbahnen des Chipträgerverbunds.
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, **dadurch gekennzeichnet**, **daß** die Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen mit den Leiterbahnen (82) durch die Trägerschicht (23) des Chipträgerverbunds (74) erfolgt.
15. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, **daß** als Hilfsmittel zur Relativpositionierung des Wafers (73) gegenüber dem Chipträgerverbund (74) der Wafer mit mindestens zwei Positionierungsstiften (84, 85) versehen ist, die in korrespondierend ausgebildete Positionierungsöffnungen in der Trägerschicht des Chipträgerverbunds (74) eingreifen.
16. Verfahren nach Anspruch 11, **gekennzeichnet durch** die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung des Modulverbunds (72):
- Bereitstellung eines Wafers (73) und eines Chipträgerverbunds (74) mit einer Vielzahl auf einer gemeinsamen Trägerschicht (23) angeordneter Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen (82), wobei die Trägerschicht (23) die Rückseite des Chipkontaktbereichs (89) der Leiterbahnen (82) freigebende Öffnungen aufweist;
 - Auftragen eines fließfähigen Füllmaterials (37) auf die Kontaktoberfläche des Wafers (73) oder die Chipkontaktseite des Chipträgerverbunds (74), derart, daß die Anschlußflächen (86) des Wafers bzw. die Öffnungen (90) der Trägerschicht (23) frei bleiben;
 - Relativpositionierung des Wafers (73) und des Chipträgerverbunds (74), derart, daß sich eine Überdeckungslage zwischen den Anschlußflächen des Wafers und den Öffnungen in der Trägerschicht des Chipträgerverbunds einstellt;
 - Herstellung einer flächigen Verbindung zwischen dem Wafer (73) und dem Chipträgerverbund (74) und Kontaktierung der Anschlußflächen des Wafers mit den Chipkontaktbereichen der zugeordneten Leiterbahnen **durch** Einbringung von Verbindungsmaterial (95) in die Öffnungen (90) der Trägerschicht (23) des Chipträgerverbunds.
17. Verfahren nach Anspruch 11, **gekennzeichnet durch** die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung des Modulverbunds (72):
- Bereitstellung eines Wafers (73) und eines Chipträgerverbunds (74) mit einer Vielzahl auf einer gemeinsamen Trägerschicht (23) angeordneter Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen (82), wobei die Trägerschicht (23) auf ihrer Chipkontaktseite mit einer Kleberschicht (37) versehen ist und die Rückseite des Chipkontaktbereichs (89) der Leiterbahnen (82) freigebende Öffnungen aufweist;
 - Relativpositionierung des Wafers (73) und des Chipträgerverbunds (74), derart, daß sich eine Überdeckungslage zwischen den Anschlußflächen des Wafers und den Öffnungen (90) in der Trägerschicht (23) des Chipträgerverbunds (74) einstellt;
 - Herstellung einer flächigen Verbindung zwischen dem Wafer (73) und dem Chipträgerverbund (74) und Kontaktierung der Anschlußflächen des Wafers mit den Chipkontaktbereichen der zugeordneten Leiterbahnen **durch** Einbringung von Verbindungsmaterial (95) in die Öffnungen (90) der Trägerschicht (23) des Chipträgerverbunds.
18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, **dadurch gekennzeichnet**, **daß** die Kontaktierung durch eine Abscheidung von Verbindungsmaterial (95) in den Öffnungen (90) der Trägerschicht (23) erfolgt.
19. Verfahren nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet**, die Kontaktierung durch stromlose Abscheidung von Verbindungsmaterial in einem Materialbad erfolgt.
20. Verfahren nach Anspruch 19, **dadurch gekennzeichnet** **daß** als Materialbad ein Nickelbad verwendet wird.
21. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, **dadurch gekennzeichnet**, **daß** die Kontaktierung durch Einbringung von Lotmaterial in die Öffnungen (90) der Trägerschicht (23) erfolgt.
22. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, **dadurch gekennzeichnet**, **daß** die Kontaktierung durch Einbringung von leitfähigem Kleber in die Öffnungen (90) der Träger-

- schicht (23) erfolgt.
23. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
daß gleichzeitig mit der Einbringung von Verbindungsmaterial (95) in die Öffnungen (90) der Trägerschicht (23) eine Einbringung von Verbindungsmaterial in die Ausnehmungen (91) der Trägerschicht erfolgt.
24. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Wafer (73) auf seiner Rückseite mit einer Deckschicht versehen wird.
25. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Erzeugung der Deckschicht ein Epoxymaterial auf die Rückseite des Wafers (73) aufgebracht wird.
26. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Erzeugung der Deckschicht eine Folie auf der Rückseite des Wafers (73) aufgebracht wird.
27. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 11 bis 26,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Vereinzelung von Chipmodulen (77) aus dem Modulverbund (72) durch Trennung aneinander angrenzender Chipmodule längs definierter Trennlinien (78) erfolgt.
28. Verfahren nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Trennung mittels Sägen erfolgt.
29. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 11 bis 26,
dadurch gekennzeichnet,
daß vor der Vereinzelung über die Leiterbahnstruktur (83) des Chipträgerverbunds (74) eine elektrische Überprüfung des Wafers (73) erfolgt.
30. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet,
daß vor der Vereinzelung von Chipmodulen (77) aus dem Modulverbund (72) die Einbringung von Lotmaterial (95) in die Ausnehmungen (91) in der Trägerschicht (23) des Chipträgerverbunds (74) erfolgt.
31. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

- daß ein zur Verbindung des Chipträgers (21) bzw. des Chipträgerverbunds (74) mit der Chipoberfläche bzw. der Waferoberfläche notwendiger Verbindungsdruck mittels Vakuum erzeugt wird.
32. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Außenkontaktbereiche (26, 91) und/oder die Öffnungen (90) in einem Schablonenauftragsverfahren mit Lotmaterial (42, 95) versehen werden, wobei die Trägerschicht in einem nachfolgenden Umschmelzverfahren zur Erzeugung von Lotmaterialdepots (29) als Lötstopmaske dient.
33. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Außenkontaktbereiche (26, 91) in einem Bestückungsverfahren mit Lotmaterialformstücken (57) versehen werden.
34. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindung zwischen den Kontaktmetallisierungen (33) des Chips (22) bzw. des Wafers (73) und den Leiterbahnen (28, 82) des Chipträgers (21) bzw. des Chipträgerverbunds (74) mit einem Lötverfahren erfolgt.
35. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 34,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindung zwischen den Kontaktmetallisierungen (33) des Chips (22) bzw. des Wafers (73) und den Leiterbahnen (28, 82) des Chipträgers (21) bzw. des Chipträgerverbunds (74) mit einem Thermokompressionsverfahren erfolgt.
36. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 34,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindung zwischen den Kontaktmetallisierungen (33) des Chips (22) bzw. des Wafers (73) und den Leiterbahnen (28, 82) des Chipträgers (21) bzw. des Chipträgerverbunds (74) mit einem Ultraschallverfahren erfolgt.

Claims

1. Chip module with a chip carrier (21) and at least one chip (22, 75), wherein the chip carrier is designed as a sheet with a carrier layer (23) of plastics material and a conductor path structure with conductor paths (28), wherein the conductor paths are connected on their front to attachment faces (32) of the

- chip and have, on their rear side, external bonding regions for forming a flatly distributed attachment face arrangement for connection of the chip module to an electronic component or a substrate, wherein the conductor paths extend in a plane on the chip bonding side of the carrier layer facing the chip, and the external bonding regions are formed by recesses in the carrier layer which extend toward the rear side of the conductor paths, **characterised in that** the carrier layer (23) extends over the chip surface of the chip (22, 75), the chip carrier (21) is connected to the chip (22, 75) with interposition of a filling material (37) and the carrier layer (23) extends over the region of the attachment faces (32) of the chip (22, 75).
2. Chip module according to claim 1, **characterised in that** the carrier layer (23) is designed to be continuous over the region of the attachment faces (32) of the chip in such a way that the carrier layer (23) is closed in the region of the attachment faces (32).
 3. Chip module according to claim 1, **characterised in that** the carrier layer (23) has, in an overlap region with the attachment faces (32, 86) of the chip (22, 75), orifices (90) which extend toward the rear side (27) of the conductor paths (82) and serve to receive connecting material (95) electrically connecting the conductor paths to the associated attachment faces.
 4. Chip module according to claim 3, **characterised in that** the conductor paths (82) are arranged in the region of the orifices (90) in such a way that they only partially overlap the attachment faces (32, 86) of the chip (22, 75) with a chip bonding region (89) or the chip bonding region (89) of the conductor paths (82) is adjacent to the attachment faces (32).
 5. Chip module according to one or more of claims 1 to 4, **characterised in that** a supporting frame extending along the periphery of the chip (22) is provided.
 6. Chip module according to one or more of claims 1 to 4, **characterised by** a casting compound which connects the lateral faces of the chip (22) to a projection (49) of the chip carrier (21) protruding beyond the chip surface.
 7. Chip module according to one or more of the preceding claims, **characterised in that** the external bonding regions (26) are provided with solder material (42) of which the melting point is lower than the temperature required for the thermal connection between the contact face metallizations (33) of the chip (22) and the conductor paths (28) of the chip carrier (21).
 8. Module assembly with a chip carrier assembly and a chip assembly, in particular a wafer, with a plurality of coherently formed chip modules, according to one or more of claims 1 to 6 in which both the chip carriers and chips form a respective assembly.
 9. Process for producing a chip module according to one or more of claims 1 to 7, **characterised by** the process steps of:
 - application of a flowing filling material (37) to the chip surface or the chip bonding side (35) of the chip carrier (21);
 - pressing together of a chip bonding side (35) of the chip carrier (21) and the chip surface and bonding of the conductor paths (28) of the chip carrier (21) with the associated contact metallizations (33) of the chip (22) by backward energy loading of the conductor paths (28) issuing from the side of the carrier layer opposing the side with the conductor path arrangement with interposition of the carrier layer (23) and simultaneous displacement of the filling material (37).
 10. Process for producing a chip module according to one or more of claims 1 to 7, **characterised by** the process steps of:
 - preparing a chip carrier which is provided with an adhesive layer on the chip bonding side (35) facing the chip (22);
 - pressing together of the chip bonding side (35) of the chip carrier (21) and the chip surface and bonding of the conductor paths (28) of the chip carrier (21) with the associated contact metallizations (33) of the chip (22) by backward energy loading of the conductor paths (28) with interposition of the carrier layer (23) and simultaneous displacement of the adhesive material (37).
 11. Process for producing a chip module according to one or more of claims 1 to 7, **characterised by** the process steps of:
 - producing a module assembly (72) with a chip carrier assembly (74) and chip assembly (73) according to claim 8;
 - producing a plurality of individual chip modules (77) by isolating units consisting of at least one chip (75) and one chip carrier (76) bonded therewith from the module assembly (73).
 12. Process according to claim 11, **characterised by** the following process steps for producing the module assembly (72) :

- preparation of a wafer (73) provided with raised contact metallizations on the attachment faces (86) and of a chip carrier assembly (74) with a plurality of conductor path structures (83) with conductor paths (82) arranged on a common carrier layer (23);
 - application of a flowing filling material (37) to the bonding surface of the wafer or the chip bonding side of the chip carrier assembly;
 - relative positioning of the wafer and of the chip carrier assembly so as to adjust an overlap position between the contact metallizations of the wafer and bonding regions (89) of the associated conductor paths (82) of the conductor path structures;
 - production of a flat connection between the wafer and the chip carrier assembly and bonding of the contact metallizations of the wafer with the associated conductor paths of the chip carrier assembly.
13. Process according to claim 11, **characterised by** the following process steps for producing the module assembly (72) :
- preparation of a wafer (73) provided with raised contact metallizations on the attachment faces (86) and of a chip carrier assembly (74) with a plurality of conductor path structures (83) with conductor paths (82) arranged on a common carrier layer (23) and of an adhesive layer (37) on the chip bonding side of the carrier layer (23) ;
 - relative positioning of the wafer (73) and of the chip carrier assembly (74) so as to adjust an overlap position between the contact metallizations of the wafer and bonding regions (89) of the associated conductor paths (82) of the conductor path structures;
 - production of a flat connection between the wafer (73) and the chip carrier assembly (74) and bonding of the contact metallizations of the wafer with the associated conductor paths of the chip carrier assembly.
14. Process according to claim 12 or 13, **characterised in that** the bonding of the contact metallizations with the conductor paths (82) is achieved by the carrier layer (23) of the chip carrier assembly (74).
15. Process according to one or more of claims 12 to 14, **characterised in that**, as an aid to the relative positioning of the wafer (73) with respect to the chip carrier assembly (74), the wafer is provided with at least two positioning pins (84, 85) which engage in correspondingly formed positioning orifices in the carrier layer of the chip carrier assembly (74).
16. Process according to claim 11, **characterised by** the following process steps for producing the module assembly (72) :
- preparation of a wafer (73) and a chip carrier assembly (74) with a plurality of conductor path structures (83) with conductor paths (82) arranged on a common carrier layer (23), wherein the carrier layer (23) has orifices exposing the rear side of the chip bonding region (89) of the conductor paths (82);
 - application of a flowing filling material (37) to the bonding surface of the wafer (73) or the chip bonding side of the chip carrier assembly (74) so the attachment faces (86) of the wafer or the orifices (90) of the carrier layer (23) are exposed;
 - relative positioning of the wafer (73) and the chip carrier assembly (74) so as to adjust an overlap position between the attachment faces of the wafer and the orifices in the carrier layer of the chip carrier assembly;
 - production of a flat connection between the wafer (73) and the chip carrier assembly (74) and bonding of the attachment faces of the wafer with the chip bonding regions of the associated conductor paths by introduction of connecting material (95) into the orifices (90) in the carrier layer (23) of the chip carrier assembly.
17. Process according to claim 11, **characterised by** the following process steps for producing the module assembly (72) :
- preparation of a wafer (73) and a chip carrier assembly (74) with a plurality of conductor path structures (83) with conductor paths (82) arranged on a common carrier layer (23), wherein the carrier layer (23) is provided with an adhesive layer (37) on its chip bonding side and has orifices exposing the rear side of the chip bonding region (89) of the conductor paths (82);
 - relative positioning of the wafer (73) and the chip carrier assembly (74) so as to adjust an overlap position between the attachment faces of the wafer and the orifices (90) in the carrier layer (23) of the chip carrier assembly (74) ;
 - production of a flat connection between the wafer (73) and the chip carrier assembly (74) and bonding of the attachment faces of the wafer with the chip bonding regions of the associated conductor paths by introduction of connecting material (95) into the orifices (90) in the carrier layer (23) of the chip carrier assembly.
18. Process according to claim 16 or 17, **characterised in that** bonding is effected by deposition of connecting material (95) in the orifices (90) in the carrier

- layer (23).
19. Process according to claim 18, **characterised in that** bonding is effected by current-free deposition of connecting material in a bath of material. 5
 20. Process according to claim 19, **characterised in that** a bath of nickel is used as a bath of material.
 21. Process according to claim 16 or 17, **characterised in that** bonding is effected by introduction of solder material into the orifices (90) in the carrier layer (23). 10
 22. Process according to claim 16 or 17, **characterised in that** bonding is effected by introduction of conductive adhesive into the orifices (90) in the carrier layer (23). 15
 23. Process according to one or more of claims 16 to 22, **characterised in that** connecting material is introduced into the recesses (91) in the carrier layer simultaneously with the introduction of connecting material (95) into the orifices (90) in the carrier layer (23). 20
 24. Process according to one or more of the preceding claims, **characterised in that** the wafer (73) is provided with a surface layer on its rear side. 25
 25. Process according to claim 24, **characterised in that** an epoxy resin material is applied to the rear side of the wafer (73) to produce the surface layer. 30
 26. Process according to claim 24, **characterised in that** a sheet is applied to the rear side of the wafer (73) to produce the surface layer. 35
 27. Process according to one or more of claims 11 to 26, **characterised in that** the isolation of chip modules (77) from the module assembly (72) is effected by separating mutually adjacent chip modules along defined parting lines (78). 40
 28. Process according to claim 27, **characterised in that** separation is effected by sawing. 45
 29. Process according to one or more of claims 11 to 26, **characterised in that** electrical testing of the wafer (73) is effected prior to isolation via the conductor path structure (83) of the chip carrier assembly (74). 50
 30. Process according to claim 16 or 17, **characterised in that** solder material (95) is introduced into the recesses (91) in the carrier layer (23) of the chip carrier assembly (74) prior to isolation of chip modules (77) from the module assembly (72). 55
 31. Process according to one or more of the preceding claims, **characterised in that** a connecting pressure required to connect the chip carrier (21) or the chip carrier assembly (74) to the chip surface or the wafer surface is produced by vacuum.
 32. Process according to one or more of the preceding claims, **characterised in that** the external bonding regions (26, 91) and/or the orifices (90) are provided with solder material (42, 95) by a template application process, the carrier layer serving as a solder resisting mask in a subsequent reflow process for producing deposits of solder material (29).
 33. Process according to one or more of the preceding claims, **characterised in that** the external bonding regions (26, 91) are provided with shaped pieces of solder material (57) by an in-line process.
 34. Process according to one or more of the preceding claims, **characterised in that** the connection between the contact metallizations (33) of the chip (22) or of the wafer (73) and the conductor paths (28, 82) of the chip carrier (21) or of the chip carrier assembly (74) is produced by a soldering process. 25
 35. Process according to one or more of claims 1 to 34, **characterised in that** the connection between the contact metallizations (33) of the chip (22) or of the wafer (73) and the conductor paths (28, 82) of the chip carrier (21) or of the chip carrier assembly (74) is produced by a thermocompression process.
 36. Process according to one or more of claims 1 to 34, **characterised in that** the connection between the contact metallizations (33) of the chip (22) or of the wafer (73) and the conductor paths (28, 82) of the chip carrier (21) or of the chip carrier assembly (74) is produced by an ultrasonic process.

Revendications

1. Module à puce avec un support de puce (21) et au moins une puce (22, 75), le support de puce étant réalisé sous la forme d'une feuille et avec une couche support (23) en matière synthétique et une structure à pistes conductrices comportant des pistes conductrices (28), les pistes conductrices sur leur face avant étant reliées à des surfaces de raccordement (32) de la puce et sur leurs faces arrières présentant des zones de contact extérieures pour former un agencement de surface de raccordement réparti dans un plan, pour assurer la liaison du module à puce à un composant électronique ou à un substrat, les pistes conductrices s'étendant dans un plan sur la face de contact de puce, tournée vers la puce, de la couche support et les zones de contact

extérieures étant formées par des évidements ménagés dans la couche support, qui s'étendent jusqu'à la face arrière des pistes conductrices,

caractérisé en ce que

la couche support (23) s'étend sur la surface 5 de la puce (22, 75), le support de puce (21) étant relié à la puce (22, 75) avec agencement intermédiaire d'une matière de remplissage (37), et la couche support (23) s'étendant sur la zone des surfaces de raccordement (32) de la puce (22, 75). 10

2. Module à puce selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la couche support (23) s'étend en continu au-delà de la zone des surfaces de raccordement (32) de la puce, de manière que la couche support (23) soit fermée dans la zone des surfaces de raccordement (32) de la puce. 15
3. Module à puce selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la couche support (23) présente, dans une zone de recouvrement avec les surfaces de raccordement (32, 86) de la puce (22, 75), des ouvertures (90) s'étendant jusqu'à la face arrière (27) des pistes conductrices (82) et servant à loger du matériau de liaison (95) reliant électriquement les pistes conductrices aux surfaces de raccordement associées. 20 25
4. Module à puce selon la revendication 3, **caractérisé en ce que** les pistes conductrices (82) sont disposées dans la zone des ouvertures (90), de manière qu'une zone de contact de puce (89) des pistes conductrices (82) ne couvre les surfaces de raccordement (32, 86) de la puce (22, 75) que partiellement, ou bien que la zone de contact de puce (89) des pistes conductrices (82) est disposée au voisinage des surfaces de raccordement (32). 30 35
5. Module à puce selon une ou plusieurs des revendications 1 à 4, **caractérisé en ce qu'un** cadre d'appui est prévu le long de la périphérie de la puce (22). 40
6. Module à puce selon une ou plusieurs des revendications 1 à 4, **caractérisé par** une masse de remplissage reliant les faces latérales de la puce (22) à une zone débordante (49) du support de puce (21) dépassant la surface de la puce. 45
7. Module à puce selon une ou plusieurs des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** les zones de contact extérieures (26) sont garnies de matériau de brasure (42) dont le point de fusion est inférieur à la température nécessaire pour obtenir la liaison thermique entre les métallisations des surfaces de contact (33) de la puce (22) et les pistes conductrices (28) du support de puce (21). 50 55
8. Ensemble de modules présentant un agencement

de supports de puce et un agencement de puces, en particulier une tranche, comportant une pluralité de modules à puce attachés les uns aux autres selon une ou plusieurs des revendications 1 à 6, dans lequel tant les supports de puce, que les puces forment respectivement un ensemble.

9. Procédé de fabrication d'un module à puce selon une ou plusieurs des revendications 1 à 7, **caractérisé par** les étapes de procédé ci-après:

- application d'un matériau de remplissage (37) fluide sur la surface de la puce ou la face de contact de puce (35) du support de puce (21);
- pressage l'une sur l'autre d'une face de contact de puce (35) du support de puce (21) et de la surface de la puce et mise en contact des pistes conductrices (28) du support de puce (21) avec les métallisations de contact (33) associées de la puce (22), au moyen d'une application d'énergie par l'arrière, à partir de la face de la couche support qui est opposée à la face qui présente l'agencement de pistes conductrices, cette application d'énergie étant effectuée aux pistes conductrices (28) avec interposition de la couche support (23), avec refoulement simultané du matériau de remplissage (37).

10. Procédé de fabrication d'un module à puce selon une ou plusieurs des revendications 1 à 7, **caractérisé par** les étapes de procédé consistant à:

- fournir un support de puce, muni d'une couche d'adhésif sur la face de contact de puce (35) tournée vers la puce (22);
- presser l'une sur l'autre de la face de contact de puce (35) du support de puce (21) et de la surface de la puce et mise en contact des pistes conductrices (28) du support de puce (21) avec les métallisations de contact (33) associées de la puce (22), par application d'énergie par l'arrière aux pistes conductrices (28) avec interposition de la couche support (23), et refoulement simultané du matériau adhésif (37).

11. Procédé de fabrication d'un module à puce selon une ou plusieurs des revendications 1 à 7, **caractérisé par** les étapes de procédé consistant à:

- fabriquer un ensemble de modules (72) ayant un ensemble de supports de puce (74) et un ensemble de puces (73) selon la revendication 8;
- fabrication d'une pluralité de modules de puce (77) individuels, par individualisation d'unités

formées d'au moins une puce (75) et d'un support de puce (76), mis en contact avec elle, à partir de l'ensemble de modules (73).

12. Procédé selon la revendication 11, **caractérisé** par les étapes de procédé suivantes pour la fabrication de l'ensemble de modules (72) :

- fourniture d'une tranche (73) garnie de métallisations de contact surélevées sur les faces de raccordement (86), et d'un ensemble de supports de puce (74) ayant une pluralité de structures de pistes conductrices (83), disposées sur une couche support (23) commune, avec des pistes conductrices (82) ; 10
- application d'un matériau de remplissage (37) fluide sur la face de contact de la tranche ou la face de contact de puce de l'ensemble de supports de puce ; 15
- positionnement relatif de la tranche et de l'ensemble de supports de puce, de manière à établir une position de recouvrement des métallisations de contact de la tranche et des zones de contact (89) des pistes conductrices (82) associées des structures de pistes conductrices ; 20
- fabrication d'une liaison en surface entre la tranche et l'ensemble de supports de puce et mise en contact des métallisations de contact de la tranche avec les pistes conductrices associées de l'ensemble de supports de puce. 25 30

13. Procédé selon la revendication 11, **caractérisé** par les étapes de procédé suivantes pour la production de l'ensemble de modules (72):

- fourniture d'une tranche (73), garnie de métallisations de contact surélevées sur les faces de raccordement (86), et d'un ensemble de supports de puce (74) ayant une pluralité de structures de pistes conductrices (83) disposées sur une couche support (23) commune, avec des pistes conductrices (82) et une couche d'adhésif (37) sur la face de contact de puce de la couche support (23) ; 35
- positionnement relatif de la tranche (73) et de l'ensemble de supports de puce (74), de manière à établir une position de recouvrement des métallisations de contact de la tranche et les zones de contact (89) des pistes conductrices (82) associées des structures de pistes conductrices ; 40
- établissement d'une liaison en surface entre la tranche (73) et l'ensemble de supports de puce (74) et mise en contact des métallisations de contact de la tranche avec les pistes conductrices associées de l'ensemble de supports de puce. 45 50 55

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, **caractérisé en ce que** l'établissement du contact des métallisations de contact avec les pistes conductrices (82) se fait à travers la couche support (23) de l'ensemble de supports de puce (74).

15. Procédé selon une ou plusieurs des revendications 12 à 14, **caractérisé en ce que**, à titre de moyens auxiliaires pour obtenir le positionnement relatif de la tranche (73) par rapport à l'ensemble de supports de puce (74), la tranche est garnie d'au moins deux tiges de positionnement (84, 85) qui s'engagent dans des ouvertures de positionnement de configuration correspondante, ménagées dans la couche support de l'ensemble de supports de puce (74).

16. Procédé selon la revendication 11, **caractérisé** par les étapes de procédé suivantes pour produire l'ensemble de modules (72) :

- fourniture d'une tranche (73) et d'un ensemble de supports de puce (74) avec une pluralité de structures de pistes conductrices (83) disposées sur une couche support (23) commune, ayant des pistes conductrices (82), la couche support (23) présentant des ouvertures dégageant la face arrière de la zone de contact de puce (89) des pistes conductrices (82) ;
- application d'un matériau de remplissage (37) fluide sur la surface de contact de la tranche (73) ou la face de contact de puce de l'ensemble de supports de puce (74), de manière que les faces de raccordement (86) de la tranche ou les ouvertures (90) de la couche support (23) restent dégagées ;
- positionnement relatif de la tranche (73) et de l'ensemble de supports de puce (74) de manière à établir une position de recouvrement des surfaces de raccordement de la tranche et les ouvertures ménagées dans la couche support de l'ensemble de supports de puce ;
- fabrication d'une liaison en surface entre la tranche (73) et l'ensemble de supports de puce (74) et mise en contact des surfaces de raccordement de la tranche avec les zones de contact de puce des pistes conductrices associées, par introduction de matériau de liaison (95) dans les ouvertures (90) de la couche support (23) de l'ensemble de supports de puce.

17. Procédé selon la revendication 11, **caractérisé** par les étapes de procédé suivantes pour la fabrication de l'ensemble de modules (72):

- fourniture d'une tranche (73) et d'un ensemble de supports de puce (74) avec une pluralité de structures de pistes conductrices (83) disposées sur une couche support (23) commune,

- avec des pistes conductrices (82), la couche support (23) étant garnie d'une couche d'adhésif (37) sur sa face de contact de puce et présentant des ouvertures dégageant la face arrière de la zone de contact de puce (89) des pistes conductrices (82) ;
- positionnement relatif de la tranche (73) et de l'ensemble de supports de puce (74), de manière à établir une position de recouvrement des surfaces de raccordement de la tranche et des ouvertures (90) ménagées dans la couche support (23) de l'ensemble de supports de puce (74) ;
 - établissement d'une liaison en surface entre la tranche (73) et l'ensemble de supports de puce (74) et mise en contact des surfaces de raccordement de la tranche avec les zones de contact de puce des pistes conductrices associées, par insertion de matériau de liaison (95) dans les ouvertures (90) de la couche support (23) de l'ensemble de supports de puce.
18. Procédé selon la revendication 16 ou 17, **caractérisé en ce que** la mise en contact s'effectue par dépôt de matériau de liaison (95) dans les ouvertures (90) de la couche support (23).
19. Procédé selon la revendication 18, **caractérisé en ce que** la mise en contact s'effectue par dépôt sans courant de matériau de liaison dans un bain de matériau.
20. Procédé selon la revendication 19, **caractérisé en ce que** l'on utilise un bain de nickel comme bain de matériau.
21. Procédé selon la revendication 16 ou 17, **caractérisé en ce que** la mise en contact s'effectue par introduction de matériau de brasure dans les ouvertures (90) de la couche support (23).
22. Procédé selon la revendication 16 ou 17, **caractérisé en ce que** la mise en contact s'effectue par introduction d'adhésif conducteur dans les ouvertures (90) de la couche support (23).
23. Procédé selon une ou plusieurs des revendications 16 à 22, **caractérisé en ce que**, simultanément à l'introduction de matériau de liaison (95) dans les ouvertures (90) de la couche support (23), une introduction de matériau de liaison s'effectue dans les évidements (91) de la couche support.
24. Procédé selon une ou plusieurs des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la tranche (73) est garnie d'une couche de recouvrement sur sa face arrière.
25. Procédé selon la revendication 24, **caractérisé en ce qu'un** matériau époxyde est appliqué sur la face arrière de la tranche (73) pour former la couche de couverture.
26. Procédé selon la revendication 24, **caractérisé en ce qu'une** feuille est appliquée en face arrière de la tranche (73) pour former la couche de couverture.
27. Procédé selon une ou plusieurs des revendications 11 à 26, **caractérisé en ce que** l'individualisation des modules à puce (77) à partir d'un ensemble de modules (72) s'effectue par séparation les uns des autres de modules à puce adjacents, le long de lignes de séparation (78) définies.
28. Procédé selon la revendication 27, **caractérisé en ce que** la séparation s'effectue par sciage.
29. Procédé selon une ou plusieurs des revendications 11 à 26, **caractérisé en ce que**, avant de procéder à l'individualisation, un contrôle électrique de la tranche (73) est effectué, par l'intermédiaire de la structure à pistes conductrices (83) de l'ensemble de supports de puce (74).
30. Procédé selon la revendication 16 ou 17, **caractérisé en ce que**, avant de procéder à l'individualisation des modules à puce (77) à partir de l'ensemble de modules (72), l'introduction de matériau de brasure (95) est effectuée dans les évidements (91) ménagés dans la couche support (23) de l'ensemble de supports de puce (74).
31. Procédé selon une ou plusieurs des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'une** pression de liaison, nécessaire pour relier le support de puce (21) ou l'ensemble de supports de puce (74) à la surface de la puce ou à la surface de la tranche, est générée en utilisant du vide.
32. Procédé selon une ou plusieurs des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** les zones de contact extérieures (26, 91) et/ou les ouvertures (90) sont garnies d'un matériau de brasure (42, 94), en suivant un processus d'application avec gabarit, la couche support servant, pendant un procédé de refusion subséquent, à former des dépôts de matériau de brasure (29) faisant office de masque d'arrêt de brasure.
33. Procédé selon une ou plusieurs des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** les zones de contact extérieures (26, 91) sont munies de pièces formées (57) en matériau de brasure, selon un procédé de garnissage.
34. Procédé selon une ou plusieurs des revendications

précédentes, **caractérisé en ce que** la liaison entre les métallisations de contact (33) de la puce (22) ou de la tranche (73) et les pistes conductrices (28, 82) du support de puce (21) ou de l'ensemble de supports de puce (74) s'effectue selon un procédé de brasure. 5

35. Procédé selon une ou plusieurs des revendications 1 à 34, **caractérisé en ce que** la liaison entre les métallisations de contact (33) de la puce (22) ou de la tranche (73) et les pistes conductrices (28, 82) du support de puce (21) ou de l'ensemble de supports de puce (74) s'effectue avec un procédé de thermocompression. 10

15

36. Procédé selon une ou plusieurs des revendications 1 à 34, **caractérisé en ce que** la liaison entre les métallisations de contact (33) de la puce (22) ou de la tranche (73) et les pistes conductrices (28, 82) du support de puce (21) ou de l'ensemble de supports de puce (74) s'effectue avec un procédé aux ultrasons. 20

25

30

35

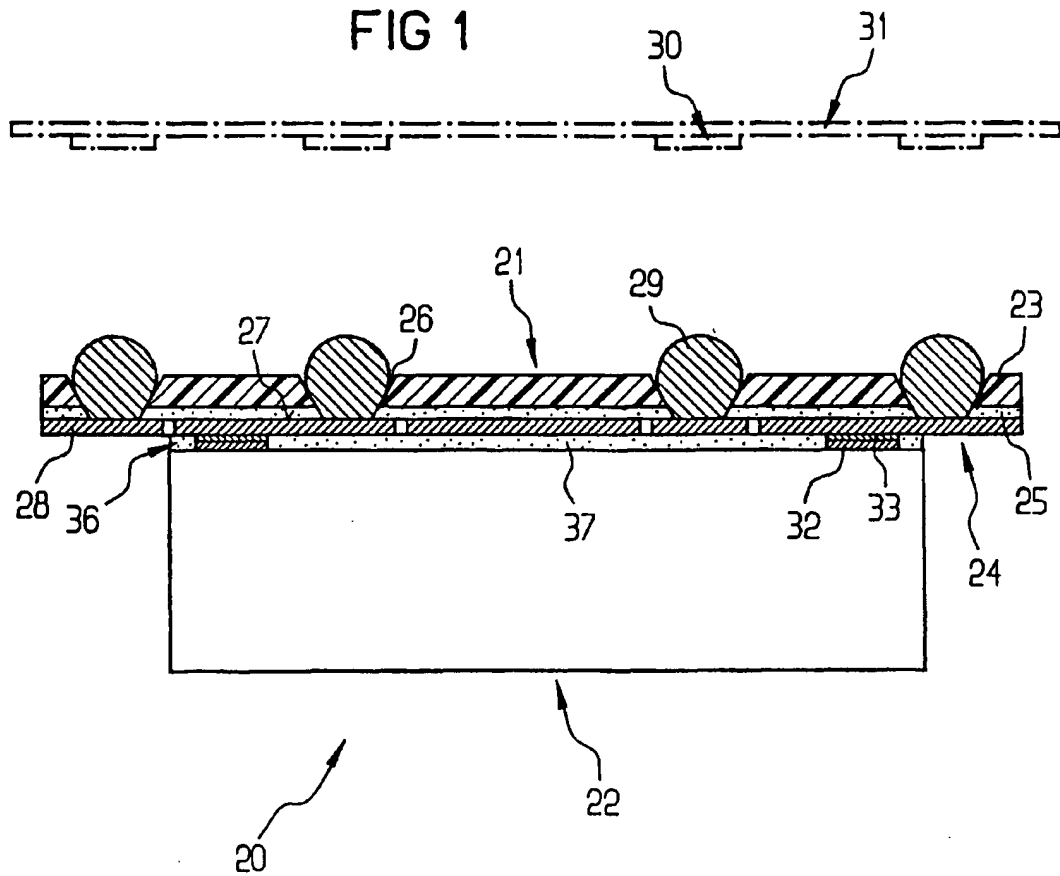
40

45

50

55

FIG 1



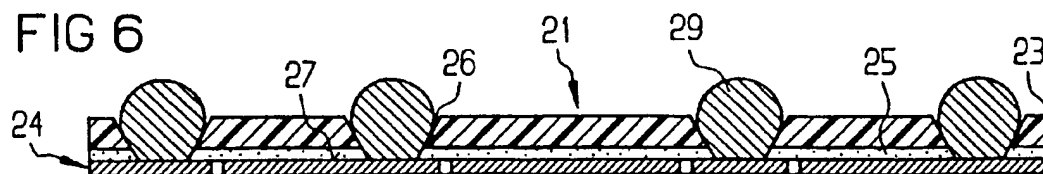
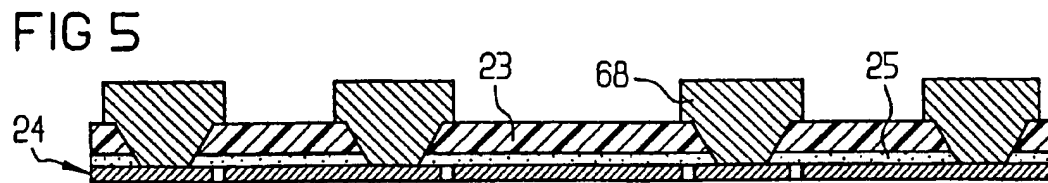
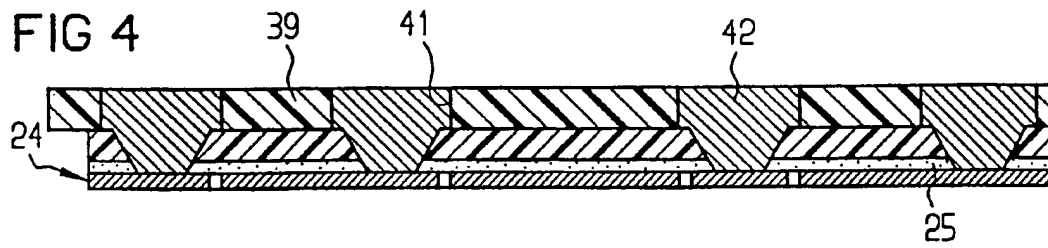
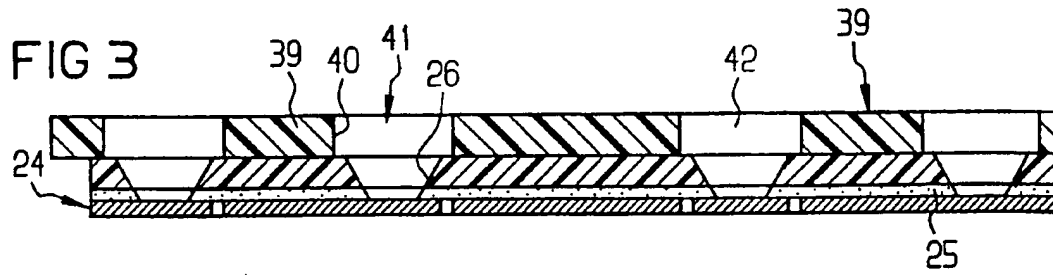
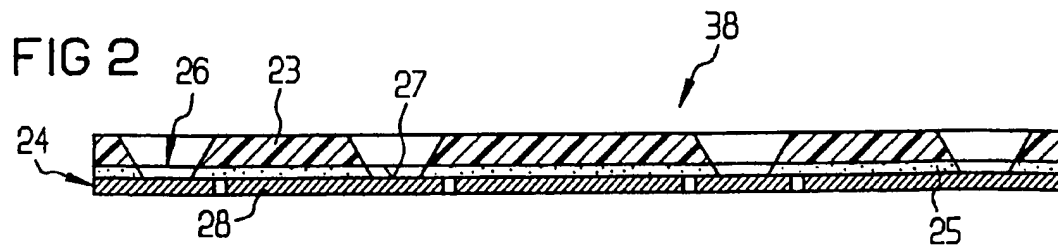


FIG 7

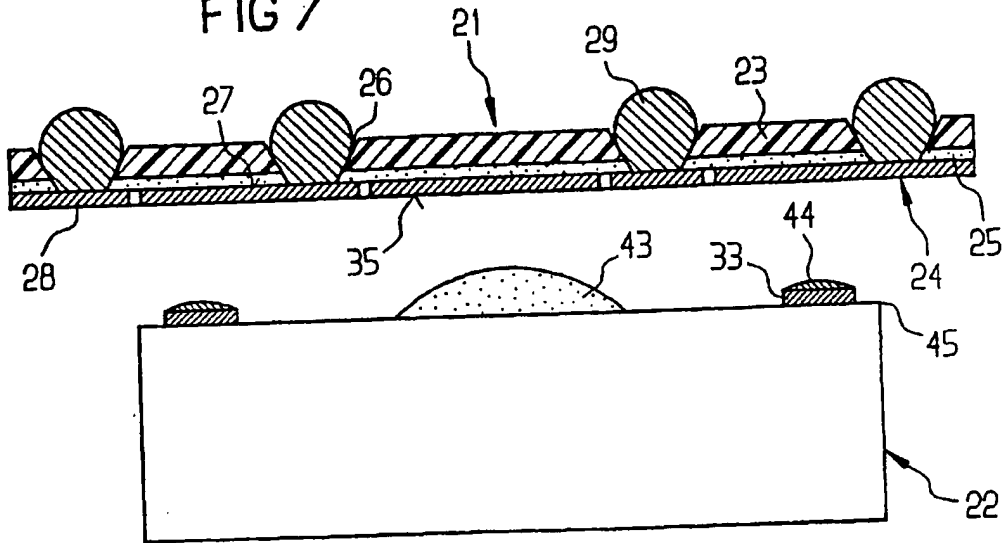
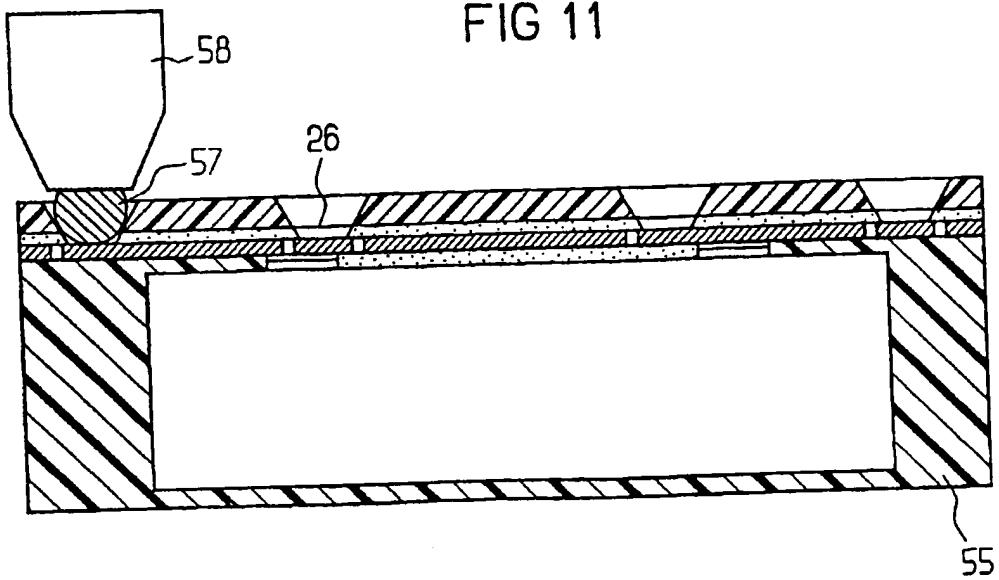
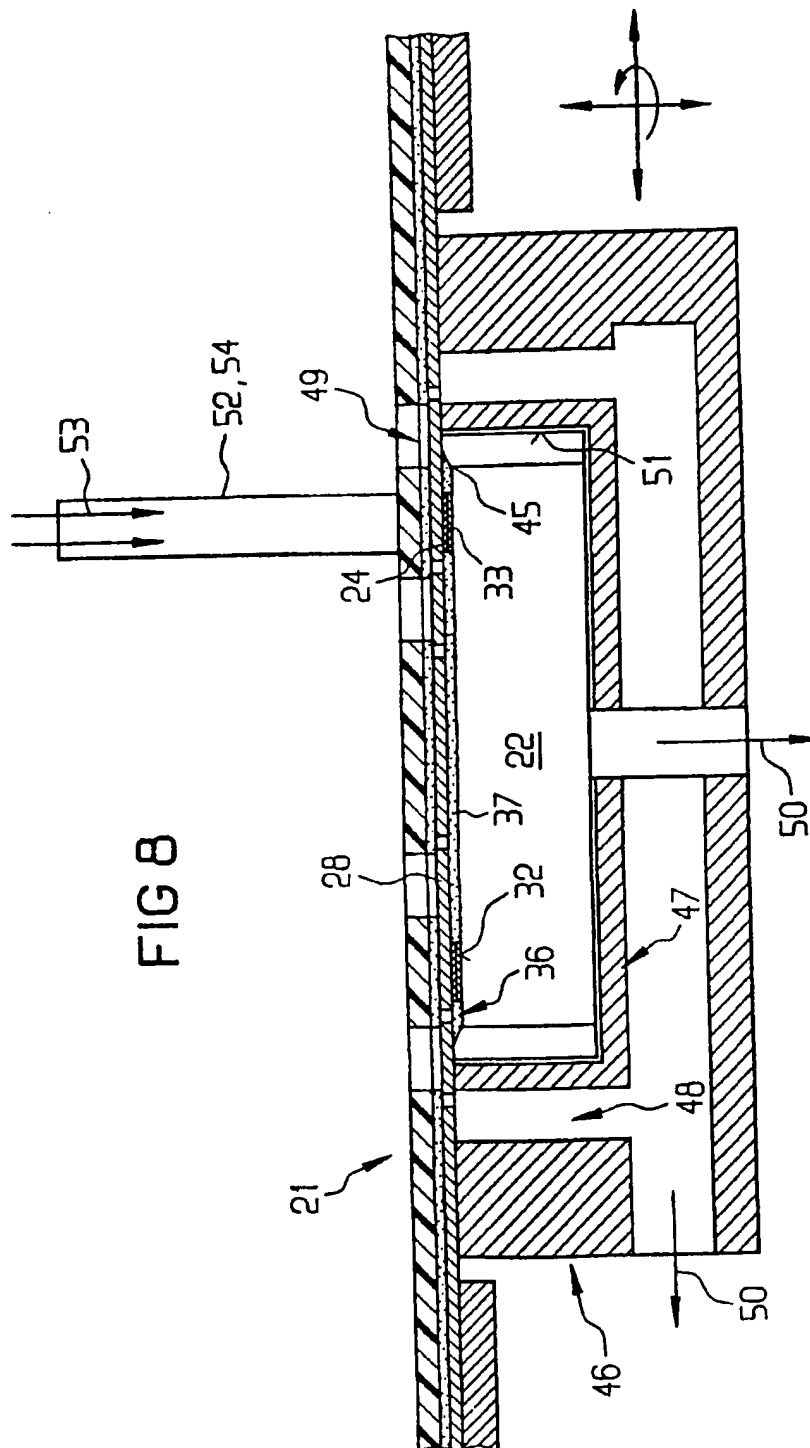


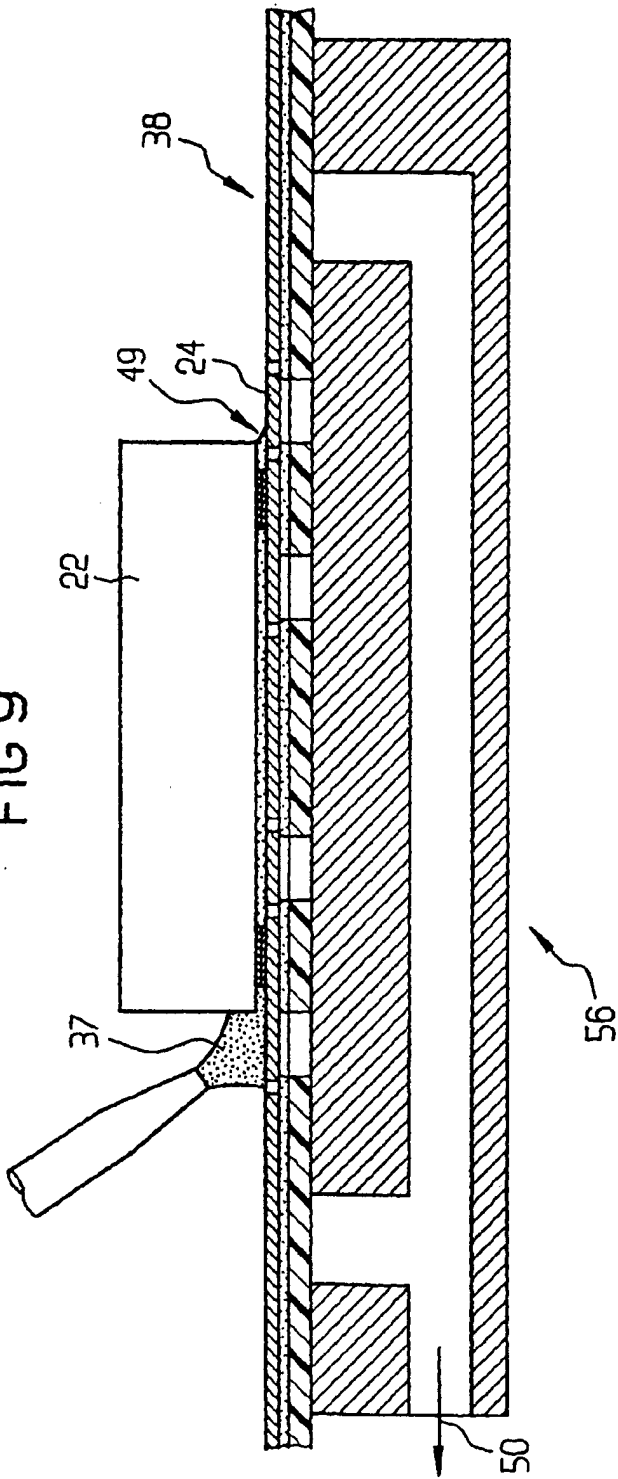
FIG 11





86/F

FIG 9



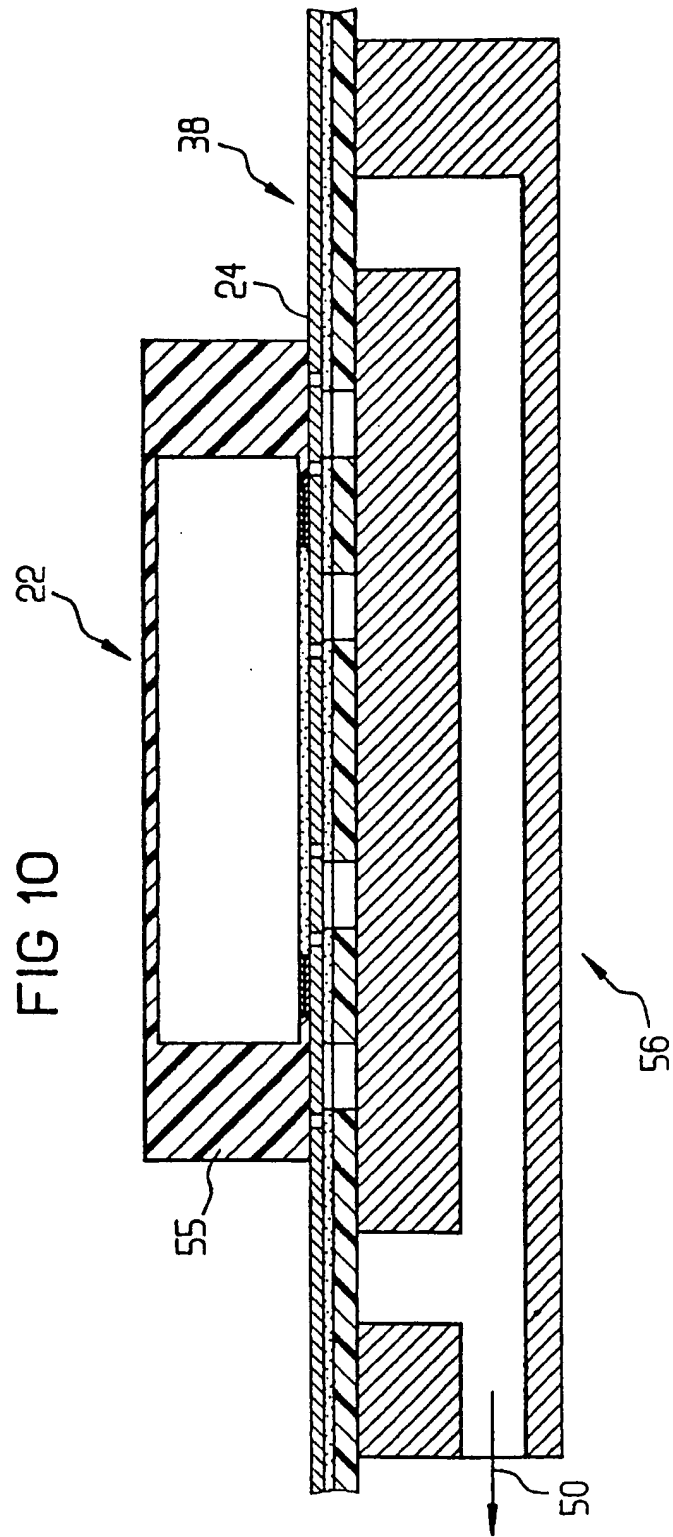


FIG 12

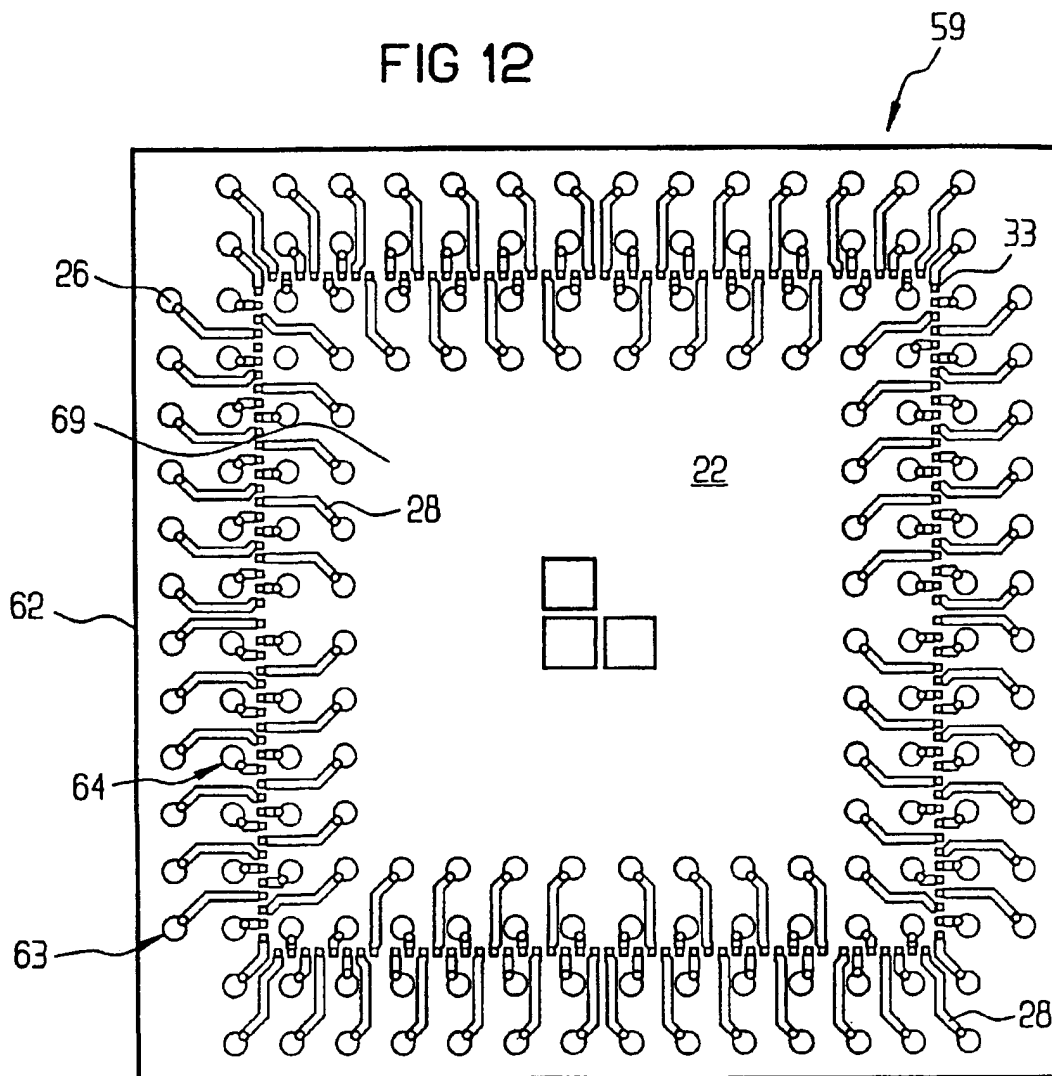


FIG 13

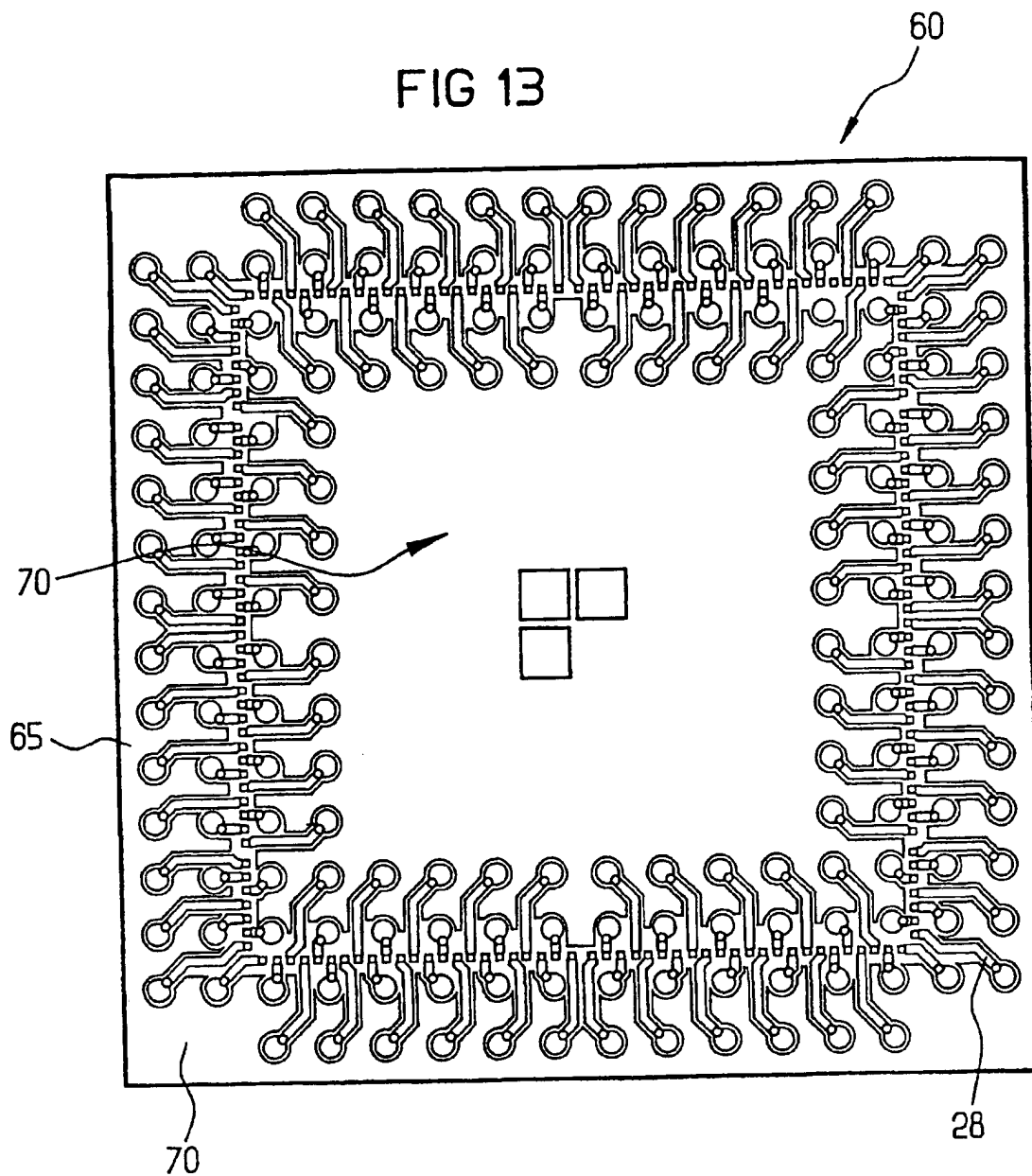


FIG 14

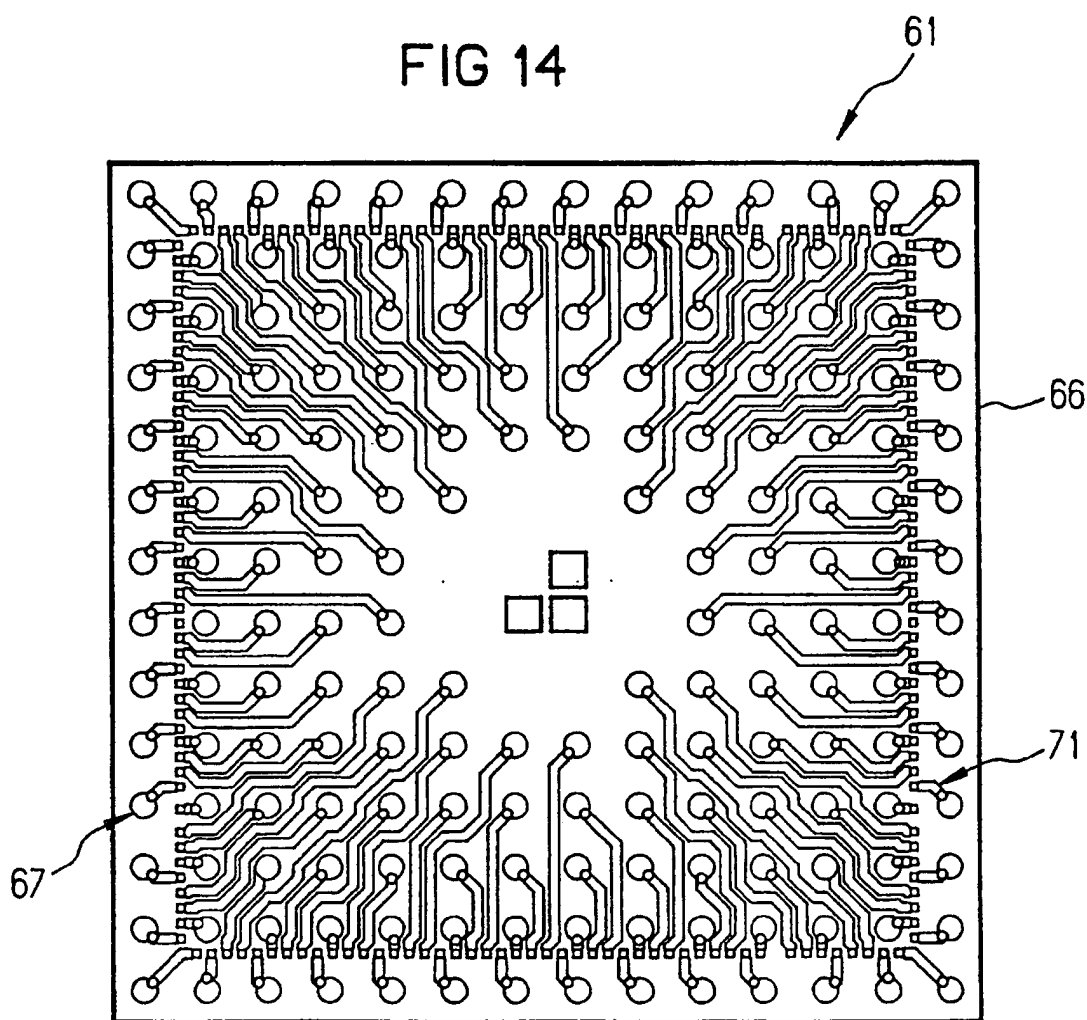


FIG 15

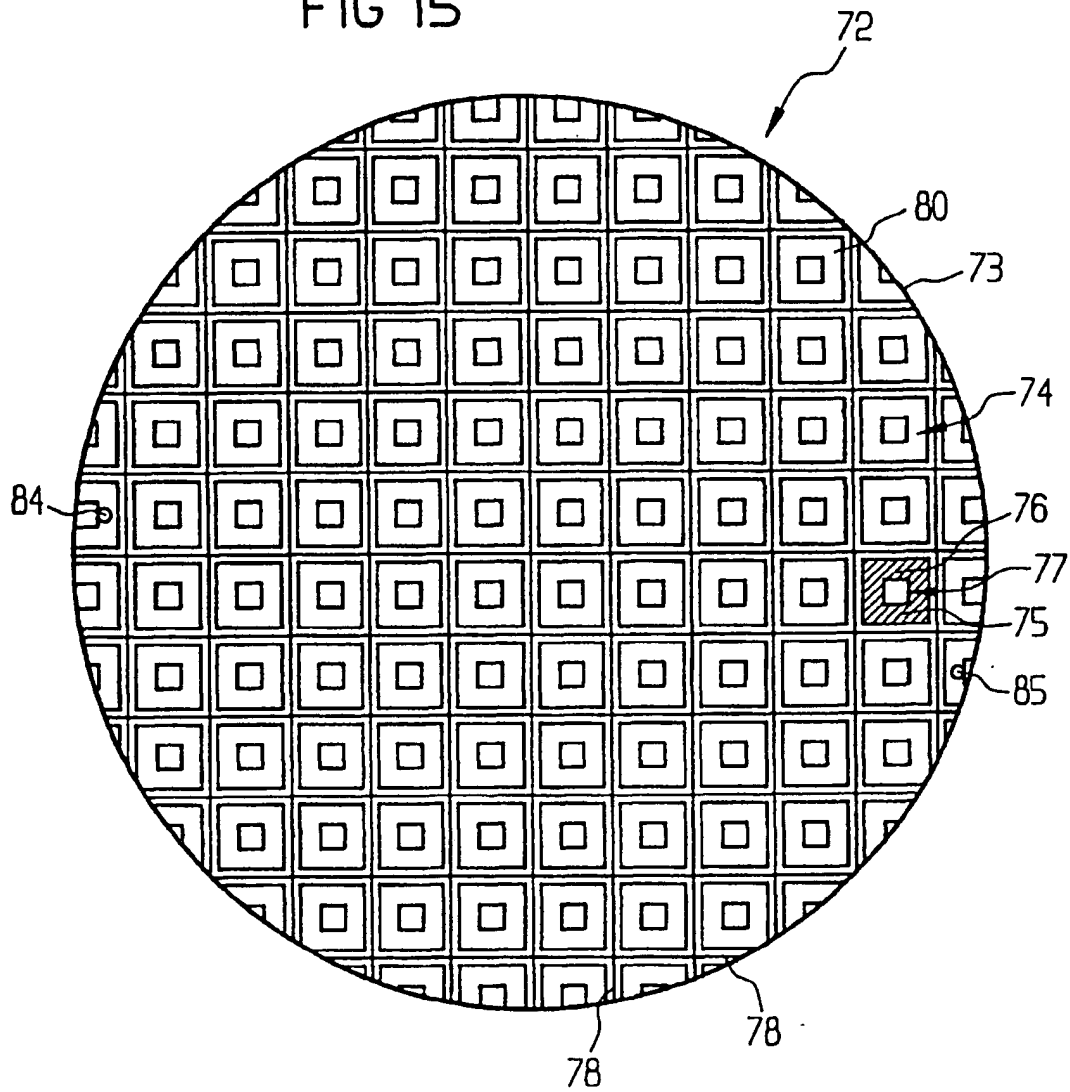


FIG 16

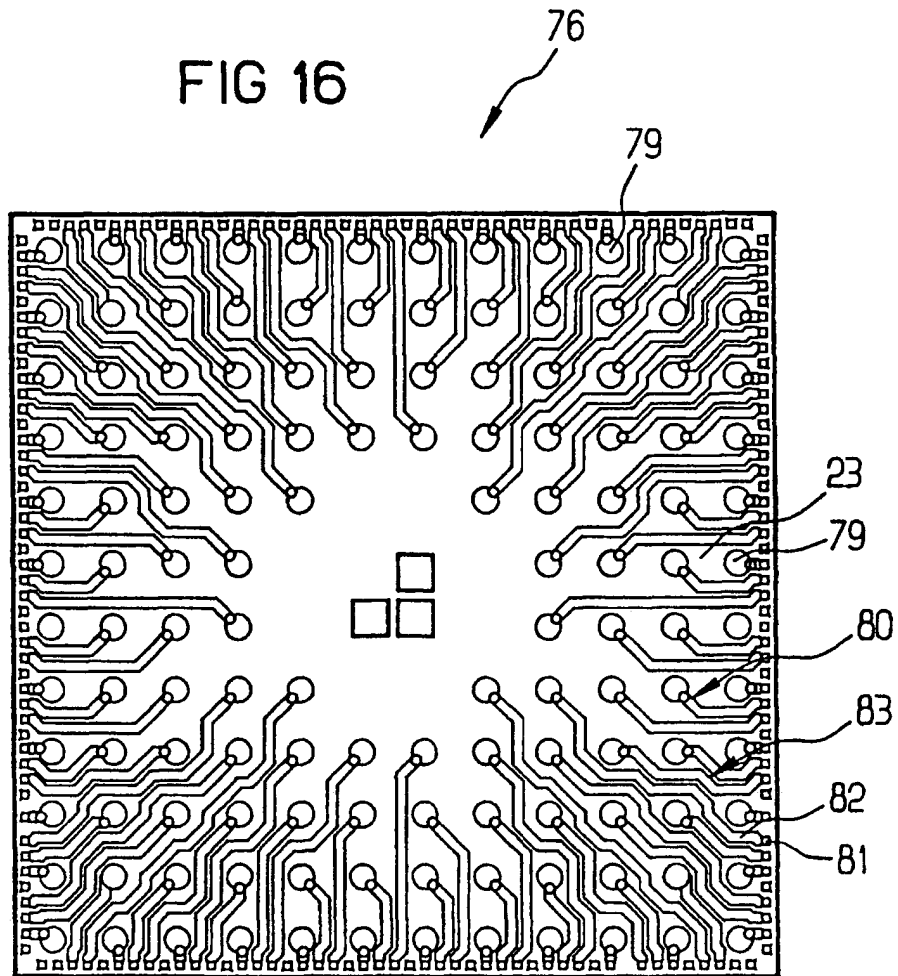


FIG 17

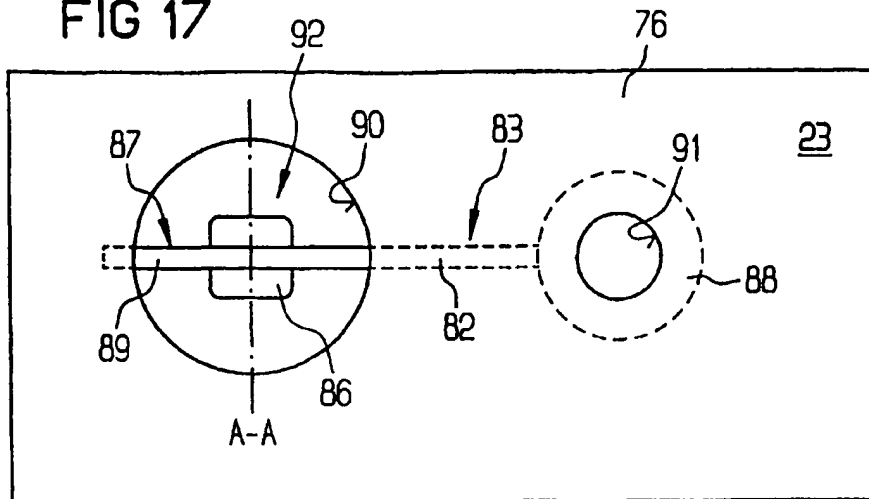


FIG 18

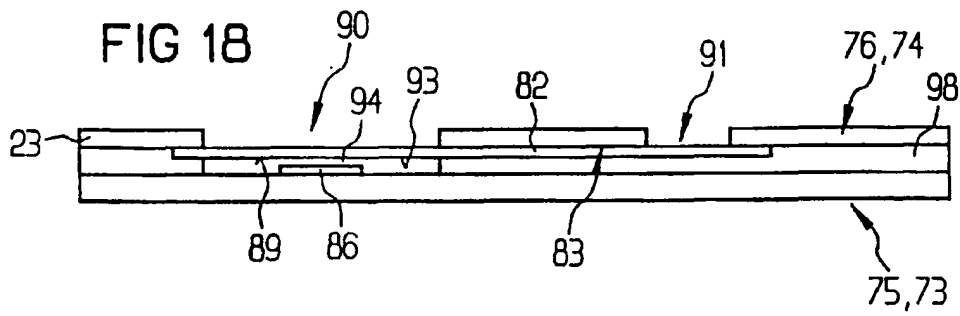


FIG 19

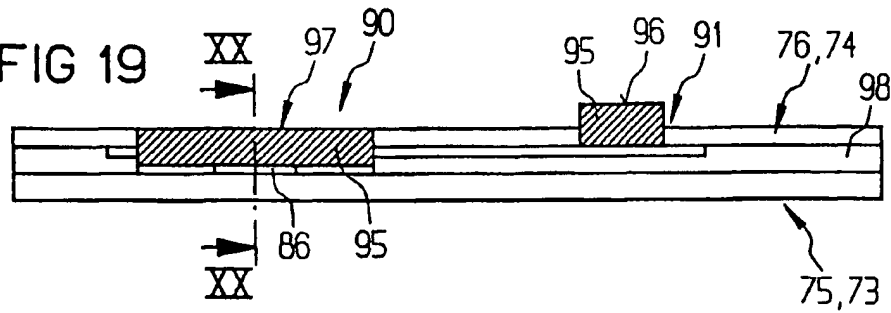
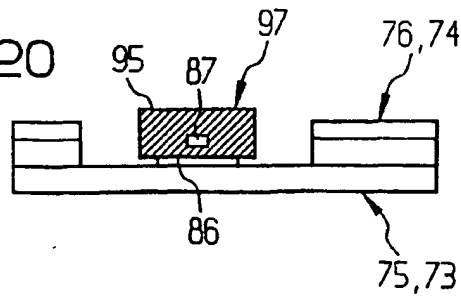







FIG 20



CHIP MODULE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

Patent number: EP0948813
Publication date: 1999-10-13
Inventor: OPPERMANN HANS-HERMANN (DE); ZAKEL ELKE (DE); AZDASHT GHASSEM (DE); KASULKE PAUL (DE)
Applicant: PAC TECH GMBH (DE)
Classification:
- international: H01L23/498
- european: H01L21/56F; H01L23/498E; H01L23/498J
Application number: EP19970913093 19971009
Priority number(s): WO1997DE02320 19971009; DE19961042358 19961014; DE19971002014 19970122

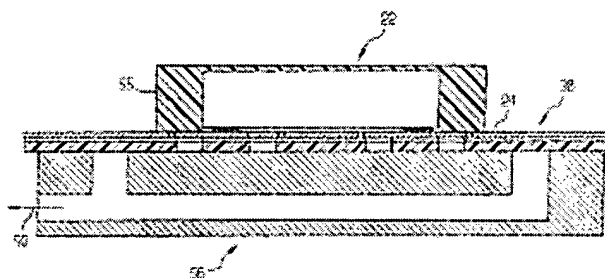
Also published as:

 WO9816953 (A1)
 US6093971 (A1)
 JP10200006 (A)
 DE19702014 (A1)
 EP0948813 (B1)

Abstract not available for EP0948813

Abstract of corresponding document: **US6093971**

Chip module (20) with a chip carrier (21) and at least one chip (22), wherein the chip carrier is designed as a sheet with a carrier layer (23) of plastics material and a conductor path structure (24) with conductor paths (28), and the chip carrier is connected to the chip with interposition of a filling material (37), wherein the conductor paths are connected on their front to attachment faces (32) of the chip and, on their rear side (27), have external bonding regions (26) for forming a flatly distributed attachment face arrangement (34) for the connection of the chip module to an electronic component or a substrate (31), and the conductor paths (28) extend in a plane on the chip bonding side (35) of the carrier layer (23) facing the chip (22), the external bonding regions (26) are formed by recesses in the carrier layer (23) which extend toward the rear side (27) of the conductor paths (28) and the carrier layer (23) extends over the region of the attachment faces (30) of the chip.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

CHIP MODULE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

Description of corresponding document: **US6093971**

BACKGROUND OF THE INVENTION

1. Field of the Invention

The present invention relates to a chip module with a chip carrier and at least one chip, wherein the chip carrier is designed as a sheet with a carrier layer of plastics material and a conductor path structure with conductor paths, and the chip carrier is connected to the chip with interposition of a filling material, wherein the conductor paths are connected on their front to attachment faces of the chip and have, on their rear, external bonding regions for forming a flatly distributed attachment face arrangement for connection of the chip module to an electronic component or a substrate. The invention also relates to a process for producing such a chip module.

Chip modules of the above-mentioned type are used, for example, to allow a flatly distributed less dense attachment face arrangement for connecting the chip to a board or the like by conventional SMT (surface mounted technology) starting from the very dense peripheral attachment face arrangement of a chip via the chip carrier provided with a conductor path structure. Sufficiently great spacing between the individual attachment faces of the attachment face arrangement has proven particularly important, in particular, because the external attachment face arrangement is generally connected to the board or the like by a reflow process. If the space between the individual attachment faces is too small, short-circuit connections between individual solder bumps of the attachment face arrangement can arise.

Owing to the increasing demand for miniaturisation of chip modules, chip modules described as "CSP" (chip size package or also chip scale package) have been developed on the basis of so-called "BGA" (ball grid array) attachment face distributions. In contrast to the above-mentioned BGAs in which the flat redistribution of the chip attachment faces over a surface area which is substantially greater than the chip surface is effected by means of correspondingly great chip carriers, an area which substantially coincides with the surface of the chip is available for the chip carrier in the chip modules designated by CSP. It has therefore proven important with the CSPs to utilise the available area as well as possible.

2. Description of the Related Art

In known CSPs, of the type known, for example, from U.S. Pat. No. 5,367,763 or from "Proceedings of the 1993 International Symposium on Microelectronics (ISHM), Dallas, Tex., pages 318-323", the edge region of the area available for the chip carrier and congruent with the surface, for the attachment connections between the attachment faces of the chip and the conductor path structure of the chip carrier is used up so the chip carrier extends only in an internal surface region reduced by the edge region. It is therefore necessary with chip modules of this design to provide the periphery of the chip surface with a separate covering, for example a casting compound, in a subsequent stage of operation in order to achieve a complete housing which also covers the attachment faces of the chip in an insulating manner.

It is accordingly the object of the present invention to propose a chip module and a process for producing a chip module which allow better utilisation of the chip surface available for the arrangement of the chip carrier, the construction of the chip module at the same time being as simple as possible.

SUMMARY OF THE INVENTION

This object is achieved with a chip module according to the invention, wherein the conductor paths extend in a plane on the chip bonding side of the carrier layer facing the chip. The carrier layer itself is therefore available for the mutually insulated arrangement of the redistributed attachment faces, so the external bonding regions for forming the flatly distributed attachment face arrangement can be formed by recesses in the carrier layer extending toward the rear of the conductor path. The carrier layer also extends over the region of the attachment faces of the chip in the chip module according to the invention so the entire chip surface is covered by the carrier layer of the chip carrier. Overall, this results in a very simple construction and correspondingly simple production of the chip module.

In a first embodiment of the chip module according to the invention, the carrier layer of the chip carrier is closed in the overlap region with the attachment faces of the chip so even this overlap region in the peripheral region of the chip carrier surface is available for the arrangement of external attachment faces on the chip carrier surface.

In a further embodiment of the chip module according to the invention, the chip carrier has a carrier layer having orifices in an overlap region with the attachment faces of the chip which extend toward the rear of the conductor paths and serve to receive connecting material electrically connecting the conductor paths to the associated attachment faces.

This embodiment of the chip module allows production during which both the recesses in the carrier layer provided for receiving connecting material for the bonding of the chip module with a board or other components and the orifices in the carrier layer can be filled with connecting material in one and the same step of the process.

The design of the chip module according to claim 4 makes the chip attachment faces readily accessible for the connecting material so high reliability of bonding is guaranteed.

If sealing or mechanical stabilisation of the assembly of chip and chip carrier is not sufficient owing to the filling material arranged between the chip and the chip carrier, a supporting frame preferably formed from the filling material can be provided along the periphery of the chip for completion. Effective mechanical stabilisation of the chip module is thus achieved in each case without the dimensions of the chip module predetermined by the chip having to be significantly increased for this purpose.

Alternatively to the above-mentioned possibility, however, it is also possible to provide sealing or mechanical stabilisation of the chip module by a casting compound of the chip which connects the lateral faces of the chip with a projection of the chip carrier projecting beyond the chip surface. This type of sealing or mechanical stabilisation of the chip module is particularly advantageous if a chip module is to be produced in the form of a chip size package in which the chip carrier surface is somewhat greater than the chip surface so the chip module has a projection of the chip carrier.

For fitting the chip module on a substrate or a board by known SMT technology, during which the external bonding regions arranged on the chip carrier surface and provided, for example, with solder material are connected to correspondingly arranged counter-bonds on the carrier layer or the board, it has proven advantageous if the external bonding regions of the chip carrier surface are provided with solder material of which the melting point is lower than the temperature required for the thermal connection between the contact metallizations of the chip and the conductor paths of the chip carrier. This ensures that the connections between the contact metallizations of the chip and the conductor paths of the chip carrier cannot be destabilised owing to the temperature loading of the chip module for producing the soldered connection between the chip carrier and the substrate or the board.

It has proven particularly advantageous for production of chip modules if the chip modules are combined according to the invention in a module assembly formed from a chip carrier assembly with a plurality of coherently formed chip carriers and a chip assembly, in particular a wafer with a plurality of coherently formed chip units or dies.

When carrying out the process according to the invention for producing chip modules, a flowing filling material is initially applied to the chip surface or the chip bonding side of the chip carrier. This filling material serves, on the one hand, for the sealed arrangement of the chip carrier on the chip and, on the other hand, for the mechanical stabilisation of the chip carrier on the chip. The filling material can also have adhesive properties for forming a flat assembly between the chip and the chip carrier. The filling material is distributed in the gap between the chip bonding side of the chip carrier and the chip surface by pressing the chip carrier and the chip together. Owing to the bonding of the conductor paths and the associated contact metallizations of the chip by a backward energy loading of the conductor paths with interposition of the carrier layer, the surface of the carrier layer of the chip carrier remains closed even during bonding so the filling material can only be displaced to the side. This ensures that the filling material covers the entire chip surface and no additional measures are required to make up filling material after production of the connection between the chip carrier and the chip. Rather, bonding of the chip carrier on the chip and stabilisation of the chip module are effected by distribution of a filling material in the gap between the chip carrier and the chip in a single operation.

An alternative process according to the invention is disclosed in which a chip carrier already provided with an adhesive layer is used instead of the application of filling material.

Furthermore, owing to the above-mentioned backward energy loading of the conductor paths for the bonding of the chip carrier on the chip and the resultant enclosure of the carrier layer of the chip carrier even in the peripheral region of the chip, it is possible to provide external bonding regions for forming the flatly distributed attachment face arrangement on the chip carrier surface.

An alternative to the above-described process according to the invention for producing individual chip modules is provided which relates to the production of individual chip modules according to the invention by isolation from a module assembly in which a plurality of chip modules formed according to the invention are formed coherently. For this purpose, the module assembly is initially produced with a chip carrier assembly and a chip assembly according to claim 8, and a plurality of individual chip modules is then produced by isolating units consisting of at least one chip and one chip carrier bonded therewith from the module assembly.

This process according to the invention therefore allows the production of chip modules on the wafer plane permitting not only the production of an individual chip module but rather the simultaneous production of a plurality of chip modules with relatively few handling or production steps.

It has proven particularly advantageous if the subsequent sequence of production steps is observed for producing the module assembly:

Firstly, there is effected the preparation of a wafer provided with raised contact metallizations, also known as so-called "bumps" in specialist jargon, and the preparation of a chip carrier assembly having a plurality of conductor path structures with conductor paths arranged on a common carrier layer, wherein the conductor path structures are allocated a respectively defined number of chips formed coherently in the wafer. A flowing filling material is then applied to the bonding face of the wafer or the chip bonding side of the chip carrier assembly, and this filling material can be, for example, an epoxy resin adhesive. Application of the filling material to the wafer can be effected as a flatly limited application in the centre of the wafer followed by distribution of the filling material over the wafer surface by rotation of the wafer round its centre axis. Before flat connection of the chip carrier assembly to the wafer, which can be achieved, for example, by a laminating process, relative positioning of the wafer and of the chip carrier assembly is effected so as to adjust an overlap position between the contact metallizations of the wafer and bonding regions of the associated conductor paths of the conductor path structures. The flat connection between the wafer and the chip carrier assembly is finally produced, for example by the above-mentioned laminating process, and the final connection can be preceded by preliminary fixing at selected points. Bonding of the contact metallizations of the wafer with the associated conductor paths of the chip carrier assembly takes place after production of the flat connection or simultaneously therewith.

With an alternate procedure a chip carrier assembly already provided with an adhesive layer is used instead of the application of filling material.

As already mentioned hereinbefore in connection with the process according to the invention for producing an individual chip module, the bonding of the contact metallizations of the wafer with the conductor paths of the chip carrier assembly by the carrier layer of the chip carrier assembly can also be effected during production of the entire module assembly, for example by backward bonding without disturbing the carrier layer in the region of the bonding points.

As an aid to relative positioning, the wafer can be provided with at least two positioning pins which engage in correspondingly formed positioning orifices in the carrier layer of the chip carrier assembly. Such positioning pins can be designed as "dummy bumps" which, without participating in the electrical connection between the wafer and the chip carrier assembly, merely engage in the carrier layer of the chip carrier assembly for the achievement and mechanical stabilisation of the relative positions. In order to define not only a rigid body orientation between the wafer and the chip carrier assembly, it may prove beneficial to provide more than two positioning pins and the corresponding number of positioning orifices, so expansion limits for, for example, thermally induced expansions in the carrier layer are created.

An alternative advantageous procedure for producing a module assembly is defined by the following process steps:

Firstly there is again prepared a wafer and a chip carrier assembly with a plurality of conductor path structures with conductor paths arranged on a common carrier layer, a chip carrier assembly with a carrier layer having orifices which expose the rear of the chip bonding region of the conductor paths and optionally adjoining ambient regions being used in this variation. A flowing filling material which, as in the above-described variation, can be designed as an epoxy resin adhesive is then applied to the bonding surface of the wafer or the chip bonding side of the chip carrier assembly such that the attachment faces of the wafer or contact metallizations applied thereto and the orifices of the carrier layer are exposed. Relative positioning of the wafer and of the chip carrier assembly then takes place so that an overlap position is adjusted between the attachment faces of the wafer and contact metallizations constructed thereon and the orifices in the carrier layer of the chip carrier assembly. Then a flat connection is made between the wafer and the chip carrier assembly and bonding of the attachment faces of the wafer and of the contact metallizations arranged thereon with the chip bonding regions of the associated conductor paths is effected by introduction of connecting material into the orifices in the carrier layer of the chip carrier assembly.

The above-described variation allows the production of chip modules according to the invention described at the outset in which both the connecting material deposits in the recesses of the carrier layer which serve for the bonding of the chip module with other components, and the connecting material in the orifices in the carrier layer for allowing bonding between the conductor paths of the conductor path structure and the chip attachment faces can be introduced in one operation.

Bonding can be effected by depositing connecting material in the orifices in the carrier layer, a current-free, that is autocatalytic deposition of connecting material by introduction of the module assembly into a corresponding bath of material having proven particularly advantageous in experiments. This bath of material can be, for example, a bath of nickel, copper or palladium.

Bonding can also be effected by introduction of solder material or conductive adhesive into the orifices in the carrier layer, and any known methods of introducing solder material, for example template soldering or also introduction of lumped solder material can be employed.

Simultaneously with introduction of the connecting material into the bonding orifices in the carrier layer, connecting material can be introduced into the recesses in the carrier layer.

Independently of the method of producing the module assembly, it has proven advantageous if the wafer is provided on its rear with a surface layer which can be used as surface protection and also for achieving a mechanical supporting effect. Together with the carrier layer of the chip carrier assembly, an encapsulated chip module is therefore produced after isolation of the chip modules from the module assembly.

An application of epoxy resin material to the rear of the wafer has proven useful for producing this surface layer. A further method of forming the surface layer involves applying a sheet to the rear of the wafer. The sheet can be provided with an inscription, for example for identifying individual chips of the wafer.

Independently of the method of producing the module assembly, chip modules are isolated from the module assembly by separating mutually adjacent chip modules along defined parting lines after production thereof. It has proven particularly advantageous in this connection if the sawing process employed anyway for isolating chips from a wafer assembly is carried out.

Electrical testing of the chips still arranged in the wafer assembly via the conductor path structures of the chip carrier assembly can be carried out prior to isolation of the chip modules from the module assembly, this electrical testing being particularly desirable with respect to effort and associated costs.

A particularly uniform method of pressing together for producing the connection between the chip carrier or the chip carrier assembly and the chip or the wafer is achieved if the pressing together of the chip carrier or the chip carrier assembly and the chip surface or the wafer surface is carried out by means of vacuum. If the sheet is sufficiently rigid in design or if a pull is exerted in the longitudinal direction of the sheet which is stabilised against bending, it may be sufficient to press on the chip carrier merely with the connecting device used for loading the chip carrier or the chip carrier assembly with energy. In this case, the contact pressure required to connect the conductor paths to the chip attachment faces is simultaneously used for pressing the chip carrier or the chip carrier assembly against the chip surface or

the wafer surface.

For producing solder bumps on the chip carrier or the chip carrier assembly, which serve for connecting the chip module to a substrate, a board or the like, the external bonding regions of the chip carrier or of the chip carrier assembly can be provided with solder material by a template application process, the carrier layer itself serving as a solder resisting mask in a subsequent reflow process. The solder bump can therefore be produced in a particularly simple manner.

A further method involves providing the external bonding regions with shaped pieces of solder material in an in-line process, the external bonding regions formed by the recesses in the carrier layer serving as positioning receivers for the solder material in this case.

Various processes, of which the common feature is that during backward energy loading of the conductor paths with interposition of the carrier layer the carrier layer remains substantially undamaged and closed, can be employed for the connection between the contact metallizations of the chip or of the wafer and the conductor paths of the chip carrier or of the chip carrier assembly. Soldering processes and thermocompression processes which are carried out by backward energy loading of the conductor paths with laser radiation have proven particularly suitable processes in this connection, the laser radiation being introduced through an optical fibre resting under pressure on the carrier layer at the rear. A further possibility is to employ an ultrasonic process during which an ultrasonic plunger is applied backwardly to the carrier layer and introduces ultrasonic vibrations through the carrier layer compressed in the region of the connecting point into the connecting point between the respective conductor path and the chip attachment face.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

An embodiment of the chip module according to the invention and a possible process for producing such a chip module is described in detail hereinafter with reference to the drawings.

FIG. 1 shows an embodiment of a chip module with a chip carrier bonded on a chip.

FIGS. 2 to 6 show the construction of a chip carrier.

FIG. 7 shows the chip carrier and the chip immediately prior to production of the chip module.

FIG. 8 shows the chip carrier and the chip during production of the connection between the chip carrier and the chip.

FIG. 9 shows the production of a sealing and supporting frame extending along the periphery of the chip.

FIG. 10 shows a casting compound enclosing the chip.

FIG. 11 shows the subsequent application of solder material to the chip carrier.

FIGS. 12 to 14 show several examples of flatly distributed attachment face arrangements on the chip carrier of various chip modules.

FIG. 15 shows a module assembly consisting of a wafer and a chip carrier assembly arranged thereon in a plan view.

FIG. 16 shows an enlarged detail of a chip carrier from the chip carrier assembly shown in FIG. 15.

FIG. 17 shows a detail of a connecting construction between an external attachment face of a chip carrier and a chip attachment face of a chip in a plan view.

FIG. 18 shows the connecting construction illustrated in FIG. 17 in a side view prior to application of connecting material.

FIG. 19 is an illustration of the connecting construction corresponding to the view in FIG. 18 after application of connecting material.

FIG. 20 is a sectional view of the connection between a conductor path of the chip carrier and the chip attachment face along section line XX--XX in FIG. 19.

DETAILED DESCRIPTION OF A PREFERRED EMBODIMENT

FIG. 1 shows a chip module 20 with a chip carrier 21 which is bonded on a chip 22. The chip module 20 shown in FIG. 1 is also described as a chip size package (CSP) since the essential dimensions of the chip module 20 are defined by the chip 22. A ratio of 0.8 to 1.2 between the chip surface and the surface of the chip carrier is generally used to define the size of a CSP in the specialist field.

In the chip module 20 shown in FIG. 1, a chip carrier 21 consisting of a three-layered sheet is used with a carrier layer 23 consisting of polyimide and a bonding layer which is designed as a conductor path structure 24, consists of copper and is connected to the carrier layer 23 via an adhesive layer 25. The carrier layer 23 is provided with recesses 26 extending from the surface of the carrier layer 23 to a rear side 27 of individual conductor paths 28 forming the conductor path structure 24. These recesses 26 form external bonding regions which, with deposits of solder material 29, serve for bonding with attachment faces 30 of a substrate 31 indicated in dot-dash lines in FIG. 1.

FIG. 1 shows, by way of example, two attachment faces 32 from a plurality of chip attachment faces 32 which are arranged peripherally on the chip surface and are provided with contact metallizations 33. The contact metallizations is bonded with respectively allocated conductor paths 28 so "rewiring" of the chip attachment faces 32 arranged peripherally on the chip surface into a flatly distributed attachment face arrangement 34 widened with respect to the spacing between the individual attachment faces takes place on the surface of the chip carrier 21. A filling material 37 with adhesive action which is also described as underfiller in specialist jargon is provided in a gap 36 formed between a chip bonding side 35 and the chip surface for the sealed connection of the chip carrier 21 to the chip 22 and for the mechanical stabilisation of the chip carrier 21 designed as a flexible sheet.

FIGS. 2 to 6 illustrate the production of the chip carrier 21 used for producing the chip carrier arrangement 20 in FIG. 1 in a chronological sequence. As shown in FIG. 2, the base during production of the chip carrier 21 is a three-layered sheet 38 with an adhesive layer 25 connecting the carrier layer 23 to the conductor path structure 24. In a simplified design, however, it is also possible to provide a design of a chip carrier comparable with the chip carrier 21 on the basis of a sheet in which the conductor path structure is arranged directly on the carrier layer, that is without interposition of an adhesive layer.

The sheet 38 which can be designed as a continuous sheet has in each case the recesses 26 which are provided in the carrier layer 23 and extend to the rear side 27 of the conductor paths 28, wherein the recesses can be produced, for example, by suitable etching processes or also by laser ablation.

If solder material 42 is to be introduced into the recesses 26 by a template application process to produce the solder material deposit 29 (FIGS. 1 and 6), a template 39 can be placed on the carrier layer 23, as shown in FIG. 3, more specifically such that template orifices 40 provided in the template 39 come to rest congruently with the recesses 26 in the carrier layer 23.

The solder material receivers 41 are filled with solder material 42 in the manner shown in FIG. 4 using a doctor blade or the like, not shown in detail here, after flat application of the solder material 42 on the surface of the template 39 in the solder material receivers 41 formed by superimposed recesses 26 and template orifices 40.

As shown in FIG. 5, quantities of solder material 68 formed, for example, from pasty solder material remain in the recesses 26 after removal of the template 39 from the carrier layer 23. The deposits of solder material 29 shaped in the manner of a meniscus shown in FIG. 6 are then produced by a subsequent reflow process, the carrier layer 23 serving as a solder resisting mask during reflowing.

FIG. 7 shows how the chip module 20 illustrated in FIG. 1 is formed on the basis of the chip carrier 21 produced according to the illustrations in FIGS. 2 to 6. For this purpose, there is effected an application of a defined quantity of filling material 43 to the chip surface and a preparation of the chip attachment faces 32 consisting of aluminium in the original state, corresponding to the selected process for connecting the contact metallizations 33 of the chip to the conductor paths 28 of the chip carrier 21. In the present case, the chip attachment faces 32 are provided with contact metallizations 33 designed as nickel bumps with a solder coating 44 consisting of a gold/tin alloy, to enable the bonding of the conductor paths 28 of the chip

carrier 21 to the contact metallizations 33 of the chip 22 to be carried out by a soldering process which will be described in detail hereinafter with reference to FIG. 8.

The gold/tin solder coating 44 can be applied by mere immersion of the contact metallizations 33 into an alloy which is correspondingly liquid in design.

For producing the chip module 20 (FIG. 1), that is the rigid mechanical assembly between the chip carrier 21 and the chip 22, the chip carrier 21 is pressed against the surface of the chip 22 so the quantity of filling material 43 applied to the chip surface is displaced outwardly to the periphery of the chip 22 when the gap 36 is formed between the chip bonding side 35 of the chip carrier 21 and the chip surface and is uniformly distributed over the chip surface to the outer edges 45 of the chip 22.

FIG. 8 shows that this pressing of the chip carrier 21, which is still located in the continuous sheet assembly in the illustration according to FIG. 8, can be performed by a vacuum device 46 in which the chip 22 is fixed in a chip receiver 47 and the chip carrier 21 is aspirated toward the chip surface by the effect of vacuum (arrow 50) via an annular duct 48 surrounding the chip receiver 47. It can be seen clearly in FIG. 8 that, owing to the capillary effect in the gap 36 between the chip carrier 21 and the chip 22, the filling material 37 is distributed beyond the outer edges 45 of the chip 22 so an additionally supporting effect is produced in the region of a possible projection 49 of the chip carrier 21 beyond the surface of the chip 22.

As also shown in FIG. 8, a vacuum can also be applied for fixing the chip 22 in the chip receiver 47, as indicated by the arrow 50. To prevent adhesion to the internal wall of the chip receiver 47 owing to the discharge of filling material 37 from the gap 36 in the region of the projection 49, the internal wall of the chip receiver 47 is provided with a non-stick coating 51.

As also shown in FIG. 8, the carrier layer 23 of the chip carrier 21 is loaded with laser radiation 53 via an optical fibre 52 with simultaneous application of a contact pressure to connect the conductor paths 28 of the chip carrier 21 to the contact metallizations 33 of the chip 22. The laser radiation 53 penetrates the optically transparent polyimide of the carrier layer 23 or another plastics material, which is optically transparent to laser radiation and is used as carrier layer, and is absorbed in the region of the conductor path 28 so the temperature required for the thermal connection is induced in the region of the connecting point between the conductor path 28 and the associated contact metallizations 33. Filling material 37 possibly arranged between the conductor path 28 and the contact metallizations 33 or the solder coating 24 applied to the contact metallizations 33 is displaced by the contact pressure applied by the optical fibre 52 to the carrier layer 23 so the connection cannot be impaired by filling material 37.

If necessary for achieving a plane surface of the chip carrier 21 applied to the chip 22, a central plunger tool not shown in detail in FIG. 8 can also be used for producing plane support of the chip carrier 21.

In addition to the above-described connection between the conductor paths 28 of the chip carrier 21 and the contact metallizations 33 of the chip 22 by the soldering process, it is also possible to use the connecting means shown in FIG. 8, that is the optical fibre 52 loaded with laser energy, for producing a thermocompression connection, for the preparation of which the contact metallizations 33 designed as nickel bumps is not provided with the solder coating 44 but with a thin gold coating.

According to a further method of producing the connection between the conductor paths 28 of the chip carrier 21 and the contact metallizations 33 or directly to the unprepared aluminium attachment faces 32 of the chip 22, the optical fibre 52 shown in FIG. 8 is replaced by an ultrasonic plunger which is loaded with ultrasound and transmits the ultrasonic vibrations via a compacted region of the carrier layer 23 onto the connecting region between the conductor paths 28 and the respectively allocated chip attachment faces 32.

FIGS. 9 and 10 show possibilities for mechanical stabilisation of the chip module in addition to the arrangement of the filling material 37 in the gap 36 between the chip carrier 21 and the chip 22 (underfilling). As shown in FIG. 9, additional filling material 37 can be applied for this purpose in the peripheral region along the peripheral edge of the chip 22 in the transition to the chip carrier 21 in order to form a peripheral stabilising frame.

FIG. 10 shows a process known as "moulding" in which the chip is encapsulated with a plastics composition 55.

The plastics composition 55 as well as the filling material 37 additionally applied according to FIG. 9 provide a stabilising support in the region of the projection 49 of the chip carrier 21 beyond the surface of the chip 22. As projecting deposits of solder material 29, as shown in FIG. 1, would prove undesirable in the processes shown in FIGS. 9 and 10 for the additional stabilisation of the chip carrier arrangement, in which the chip carrier sheet 38 is held on a plane face by a vacuum device 56, the deposits 29 of solder material are only produced at a later stage in these cases. For this purpose, as shown in FIG. 11, shaped pieces of solder material 57 can be placed in the recesses 26 before or after separation of the chip carriers 21 connected to the chip 22 from the chip carrier sheet 38 and can then be remelted to form the solder material deposits 29. In the embodiment illustrated in FIG. 11, the shaped pieces of solder material 57 are spherical in shape and are placed in the recesses 26 by a solder bead positioning device 58.

Chip modules 59, 60 and 61 of different designs are shown by way of example in FIGS. 12, 13 and 14. The selected view corresponds roughly to a section between the carrier layer 23 and a respective bonding layer 69, 70, 71 comprising the conductor paths 28. FIG. 12 shows the chip module 59 with a so-called "two-row fan-out" configuration in which a flat redistribution takes place on the basis of the peripheral single-row arrangement of the contact metallizations 33 of the chip 22 over the bonding layer 69, in a chip carrier 62 in which two rows 63, 64 of external bonding regions 26 are arranged outside the periphery of the chip.

FIG. 13 shows a corresponding configuration in which a chip carrier 65 is used, in whose bonding layer 70 not only the conductor paths 28 consist of copper but also the entire bonding layer 70 consists of copper, the conductor path 28 being separated from the remaining copper material by etching. The chip carrier 65 shown by way of example in FIG. 13 is therefore distinguished by particularly high rigidity.

Finally, FIG. 14 shows a chip carrier 66 with a so-called single-row fan-out configuration in which only one row 67 of external bonding regions 26 is arranged outside the periphery of the chip and all other external bonding regions 26 are distributed within the periphery of the chip.

FIG. 15 shows a module assembly 72 with a wafer 73 and a chip carrier assembly 74, arranged on the wafer 73, with a plurality of chip carriers 76 arranged coherently on the common carrier layer 23. As can be inferred from the illustration in FIG. 15, the wafer has a plurality of coherently formed chips 75 which are allocated a respective chip carrier 76 from the chip carrier assembly 74. For the isolation, following production of the module assembly 72 shown in FIG. 15, of chip modules 77 which are formed respectively of a chip 75 and a chip carrier 76 in the present case, parting grooves 78 are provided on the wafer 73, along the course of which the module assembly 72 can be isolated into the chip modules 77 by sawing or other suitable parting processes.

In one embodiment, the chip modules 77 isolated from the module assembly 72 can coincide with respect to their design substantially with the chip module 20 shown in FIG. 1, with the difference that the chip carrier 76, in contrast to the chip carrier 21 shown in FIG. 1, extends with its outer edges substantially flush with the lateral edges of the chip and does not project laterally beyond it, as shown in FIG. 1.

A chip carrier 76 of this type is shown in a plan view in FIG. 16 and, on the basis of the chip bonding regions 81, allows a so-called fan-in distribution of attachment faces 79 of an attachment face arrangement 80 on the carrier layer 23 of the chip carrier 76. The attachment face arrangement 80 of the chip carrier 76 is shown in simplified form in FIG. 15 by a frame-like hatched line.

Apart from the above-mentioned difference from the construction of the chip module 20 shown in FIG. 1 in that a design of the chip carrier 76 which is substantially flush with the chip surface is required for producing a chip module 77, all process steps shown in FIGS. 2 to 7 can be carried out for producing the module assembly shown in FIG. 15 with the difference that a plurality of chips 75 formed coherently in the wafer 73 can be used instead of an individual chip 22 and a plurality of chip carriers 76 formed coherently in the chip carrier assembly 74 can be used instead of an individual chip carrier 21. Chip modules 77 are therefore produced by isolating the chip modules 77 from a module assembly 72 previously produced, for example, by the process steps shown in FIGS. 2 to 7.

In order to prevent the formation of air inclusions between the chip carrier assembly and the surface of the wafer 73 if the chip carrier assembly 74 is applied to the wafer 73 over a large area—for example as shown in FIG. 7 with respect to the production of the individual chip module 20—the chip carrier assembly can be provided with parting lines not shown in detail in FIG. 15 and designed as lines of perforations which are congruent with the parting lines 78 of the wafer 73, split the individual chip carriers 76 from one another

and simultaneously allow the escape of air through the perforations to prevent the above-mentioned inclusions of air.

To allow correct relative positioning of the chip carrier assembly 74 with respect to the wafer 73 with corresponding overlapping layers shown in FIG. 15 between the individual chip carriers 76 and the chips 75 which allow bonding between the chip bonding regions 81 at the ends of conductor paths 82 of conductor path structures 83 allocated to the individual chip carriers 76, the wafer 73 can be provided, on its surface, with positioning pins 84, 85 which engage in correspondingly designed positioning orifices, not shown in detail here, in the carrier layer 23 of the chip carrier assembly 74. The positioning pins 84, 85 can be formed by raised bumps in the edge region of the wafer 73 of incompletely formed chips. Like the other bumps of the functional chips 75 not shown in detail here, the bumps of the wafer can basically be produced by, for example, autocatalytic deposition of material or immersion soldering.

FIGS. 17 to 20 show the production, differing from that in FIGS. 2 to 7, of the assembly between a chip and a chip carrier or a wafer and a chip carrier assembly by the example of the connection between a chip attachment face 86 and a conductor path 82 of a chip carrier 76. As will be described hereinafter, the construction of the connection shown in FIGS. 17 to 20 allows particularly inexpensive production of chip modules 77 on the wafer plane (FIG. 15).

As shown by the plan view of a cut out region of the chip carrier 76 in FIG. 17 compared with the corresponding side view in FIG. 18, the chip carrier 76 in the present case consists of the carrier layer 23 with a conductor path structure 83 which is arranged on the underside thereof and of which only one conductor path 82 is shown here. The conductor path 82 is composed in the present case of a rod conductor 87 and a circular flat conductor 88. The conductor path 82 is arranged on the underside of the carrier layer 23 such that a chip bonding region 89 of the rod conductor 87 and the circular flat conductor 88 of the conductor track 82 are located beneath an orifice 90 or a recess 91 in the carrier layer 23. The recess 91 is limited at the bottom by the rear of the circular flat conductor 88 of the conductor path 82. The orifice 90 in the carrier layer 23 extends to the rear of the rod conductor 87 of the conductor path 82 and also exposes an ambient region 92 which surrounds the chip bonding region 89 of the rod conductor 87 and, as shown in FIG. 17, extends beyond the chip attachment face 86.

As shown in FIG. 18, an adhesive layer 98 provided for producing the assembly between the chip carrier assembly 74 and the wafer 73 is arranged such that a connecting face 93 substantially congruent with the face of the orifice 90 is formed on the surface of the wafer 73 or of the chip 75 in whose internal region the chip attachment face 86 is arranged. FIG. 18 also shows that a bonding gap 94 is formed between the surface of the chip attachment face 86 and the underside of the rod conductor 87 of the conductor path 82.

FIG. 19 shows the recess 91 in the chip carrier 76 of the chip carrier assembly 74 and the orifice 90 in the chip carrier 76 extending to the surface of the wafer 73 in the ambient region 92 after introduction of a connecting material 95. The orifice 90 in the region of the chip attachment face 86 and of the chip bonding region 89 of the conductor path 82 and the bonding gap 94 are filled with the connecting material 95 so, as shown in the sectional view in FIG. 20, the conductor path 82 is completely enclosed in the chip bonding region 89 with a secure connection to the chip attachment face 86. This complete enclosure is a result of the all-round growth of the connecting material 95 during the deposition process. An increase in the bonding gap 94 is also produced.

A particular advantage of the connecting construction shown in FIGS. 17 to 20 is that both the recess 91 and the orifice 90 in the chip carrier 76 can be filled with connecting material 95 in one and the same process step so, on the one hand, external bonding bumps 96 are created for the external attachment face arrangement 80 of the chip carrier 76 and, on the other hand, internal connections 97 between the wafer 73 or the chips 75 formed coherently thereby and the chip carriers 76 are created.

The orifices 90 in the chip carrier assembly 74 are sufficiently great so the chip attachment faces 86 of the wafer 73 can be cleaned prior to introduction of connecting material 95, which can be effected, for example, by autocatalytic deposition of nickel or the like, and/or can be provided with a coating, for example zincate or an intermediate nickel layer.

The connecting material can be introduced particularly advantageously by immersion of the wafer 73 or guidance of the wafer 73 into or through a bath of material.

In contrast to the rod-shaped geometry of the conductor path 82 shown in FIGS. 17 to 20 in the region of the orifice 90, other conductor path geometries are also possible which promote and utilise the above-described growth of the connecting material in a particular manner during the deposition process to form the connection between the chip attachment 86 and the conductor path 82. The conductor path 82 can therefore have an annularly designed chip bonding region of which the internal diameter is dimensioned such that the connecting material construction on the chip attachment face 86 grows through the ring so to speak owing to the deposition process and thus contributes to the formation of the connection. The annularly designed chip bonding region can be covered by the edge of the orifice 90 or can be exposed. In particular in the case of an annular chip bonding region covered by the edge of the orifice 90 in the carrier layer 23, a surface of the internal connection formed substantially flush with the surface of the chip carrier 76 or the chip carrier assembly 74 can be achieved without special measures being required for this purpose. The orifice 90 can basically be greater or smaller than the chip attachment face but can also be equally great.

Other methods of influencing the formation of the surface of the internal connection by the design of the conductor path 82 in its chip bonding region 89 via the geometry of the conductor path 82 involve making the conductor path 82 square in the form of a frame, slit-shaped or even cross-shaped in this region.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.